Freie Universität Berlin

Kapitel 5:
Halbleiter und Unipolare Transistoren

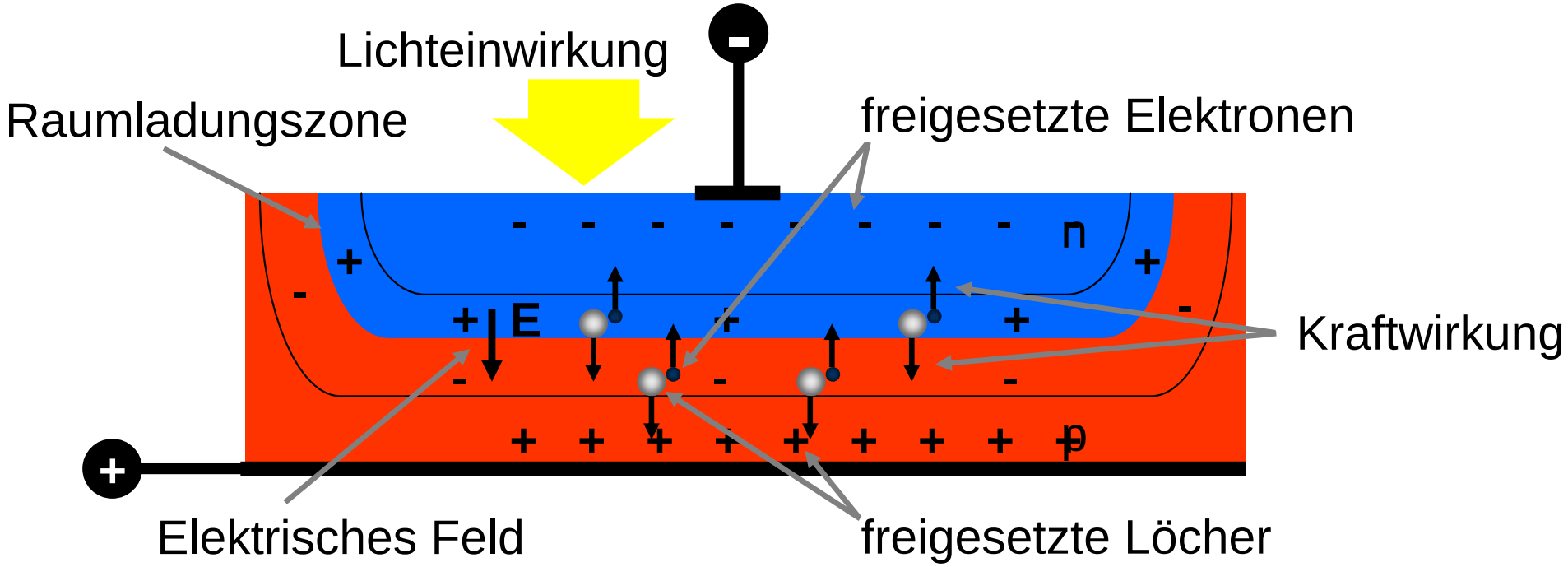
- Optoelektronische Bauelemente
- Unipolare Transistoren
- J-FET Transistor
- MOS-FET Transistor
  - Anreicherungstyp selbst sperrend
  - Verarmungstyp selbst leitend
- MOS-FET
  - Schalter
  - Verstärker
  - Inverter
  - Tristate
  - Transmissionsgatter
- Vergleich Bipolar- und Unipolartechnik
- Anwendungsbeispiele

Optoelektronische Bauelemente

- Solarzelle
- Fotodiode
- Fototransistor
- Leuchtdiode
- Optokoppler

Solarzelle

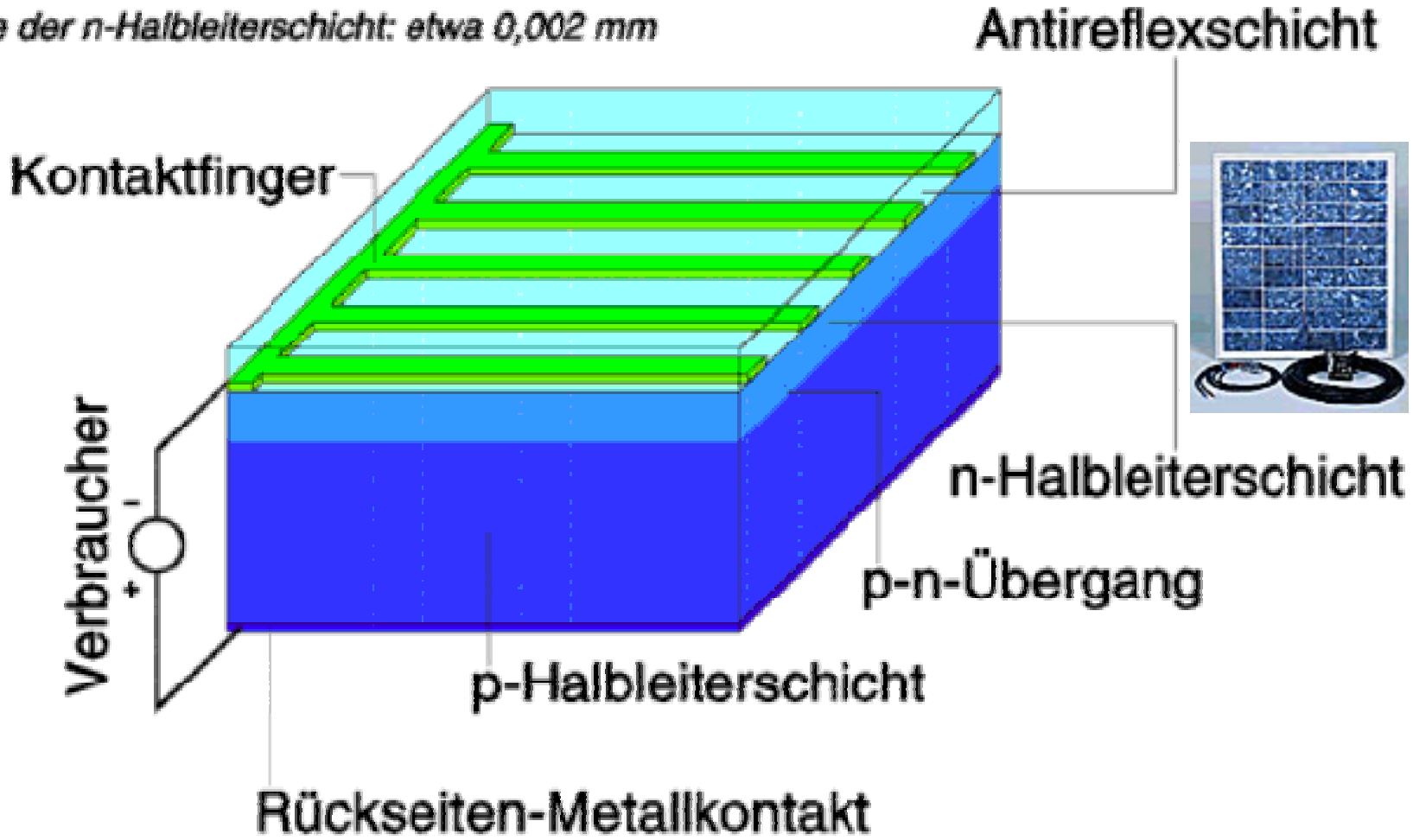
Durch Lichteinwirkung werden Elektronen in der Raumladungszone von den Atomen freigesetzt und durch das Elektrische Feld in Richtung der negativen Elektrode beschleunigt. Dort bildet sich ein Elektronen-überschuß. Die freigesetzten Löcher wandern in Richtung der positiven Elektrode und bilden dort einen Elektronenmangel.



Solarzelle

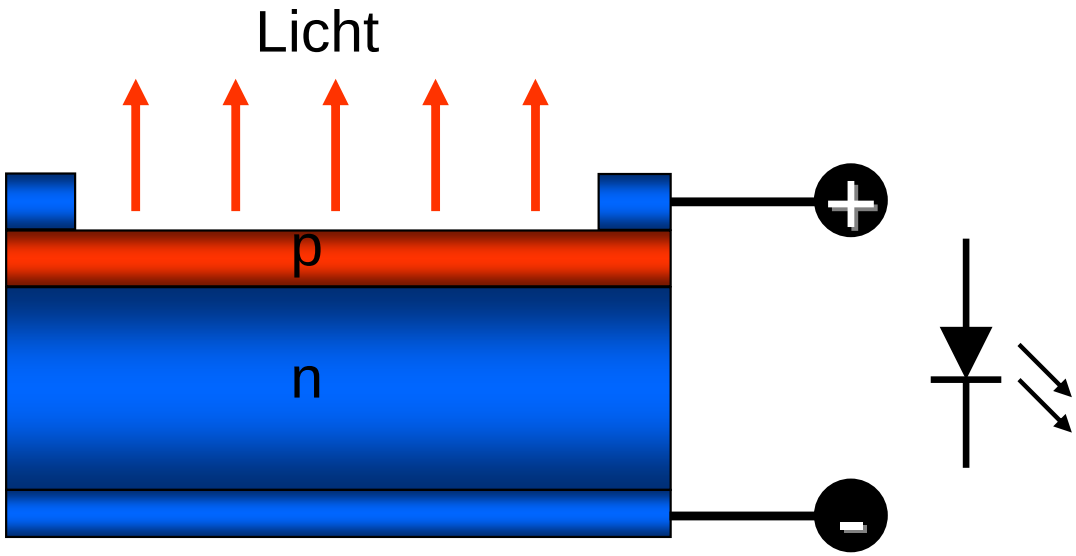
Dicke der Solarzelle: etwa 0,1 - 0,3 mm

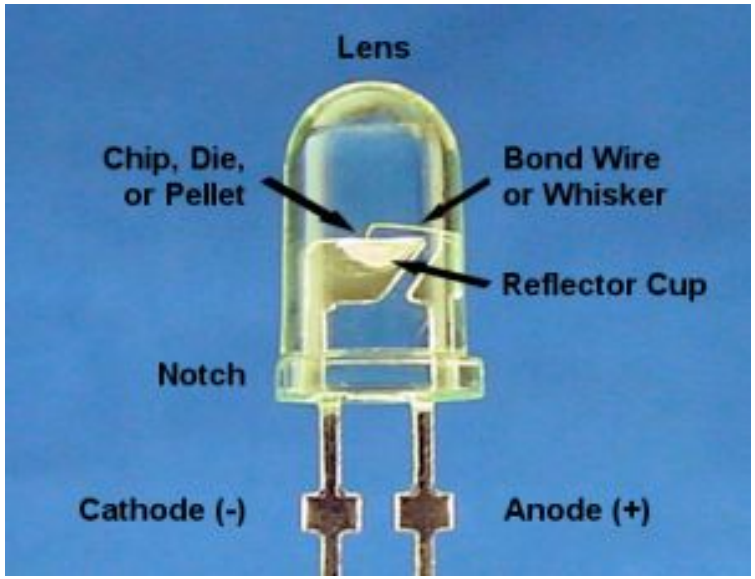
Dicke der n-Halbleiterschicht: etwa 0,002 mm



LED Leuchtdiode

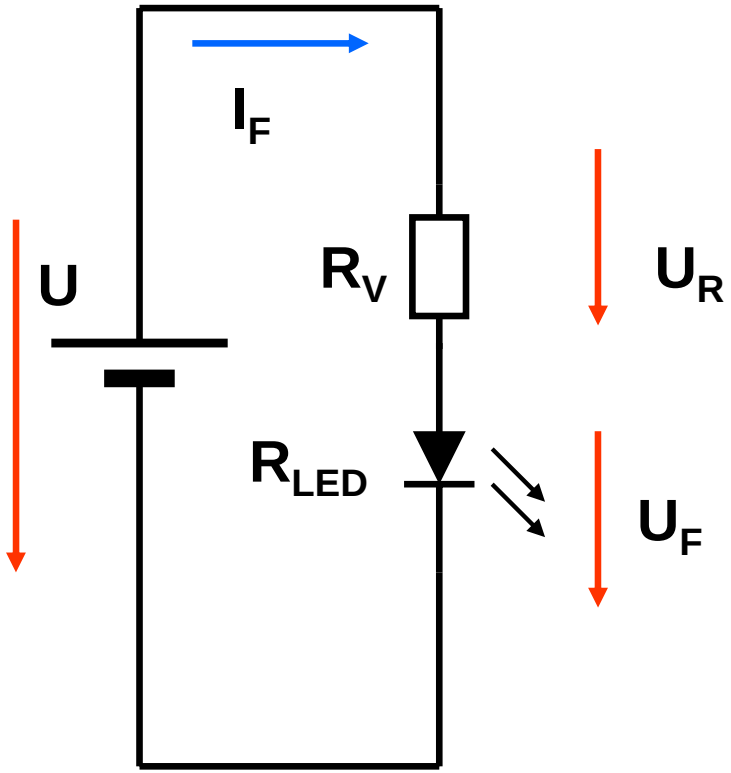
Licht emittierende Diode





Die Elektronen wandern von der n-Zone in die p-Zone. Es kommt zu Rekombinationen. Die Elektronen „fallen“ in die Löcher, dabei wird Energie in Form von Licht frei.

LED Leuchtdiode



$$R_{LED} = \frac{U_F}{I_F}$$

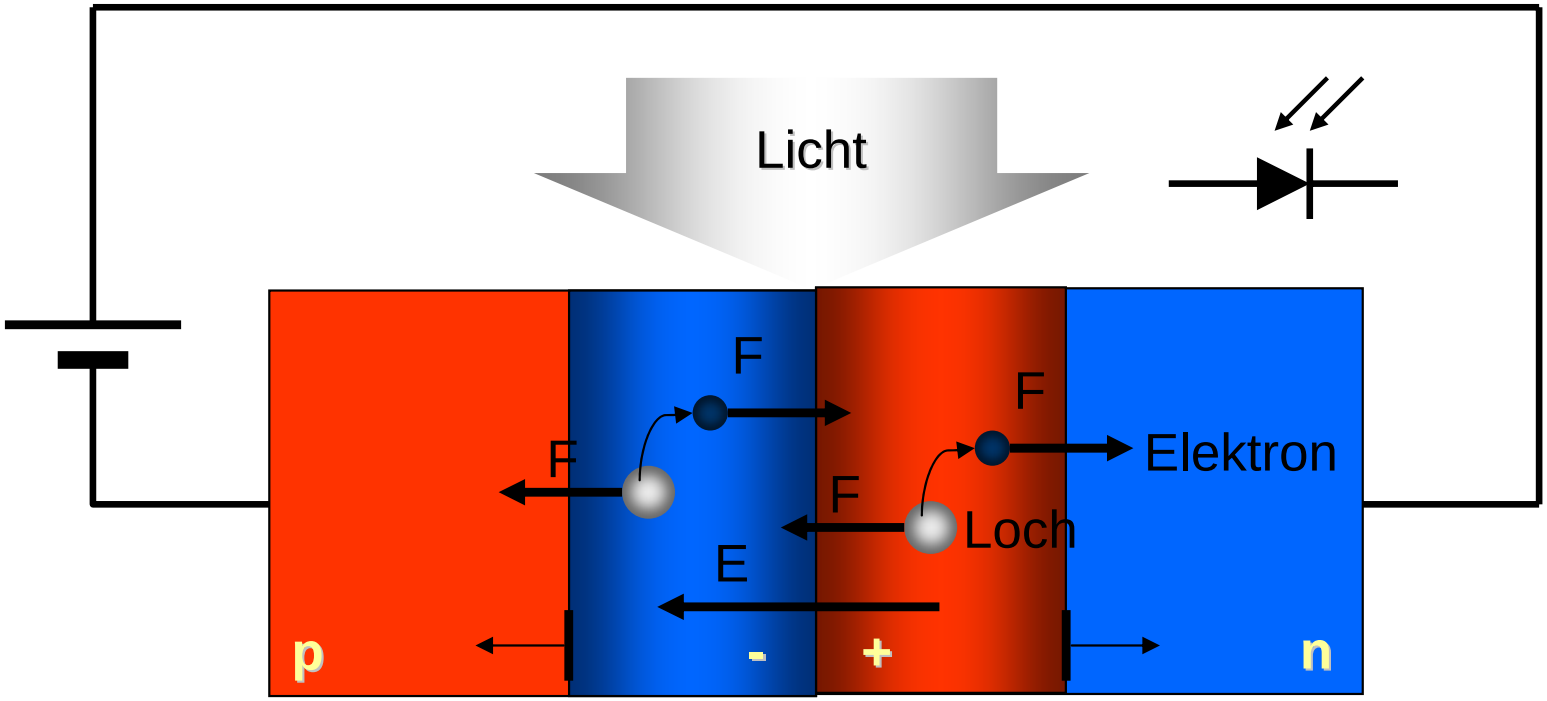
$$U_R = U - U_F$$

$$R_V = \frac{U_R}{I_F} = \frac{U - U_F}{I_F}$$

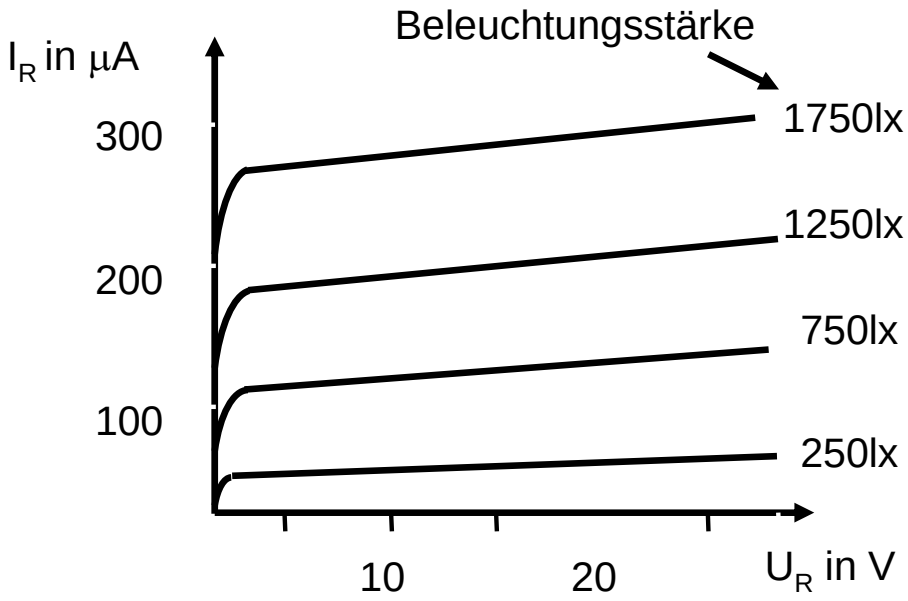
$$R_{V_Beispiel} = \frac{U - U_F}{I_F} = \frac{5V - 1{,}8V}{10mA} = 320\Omega$$

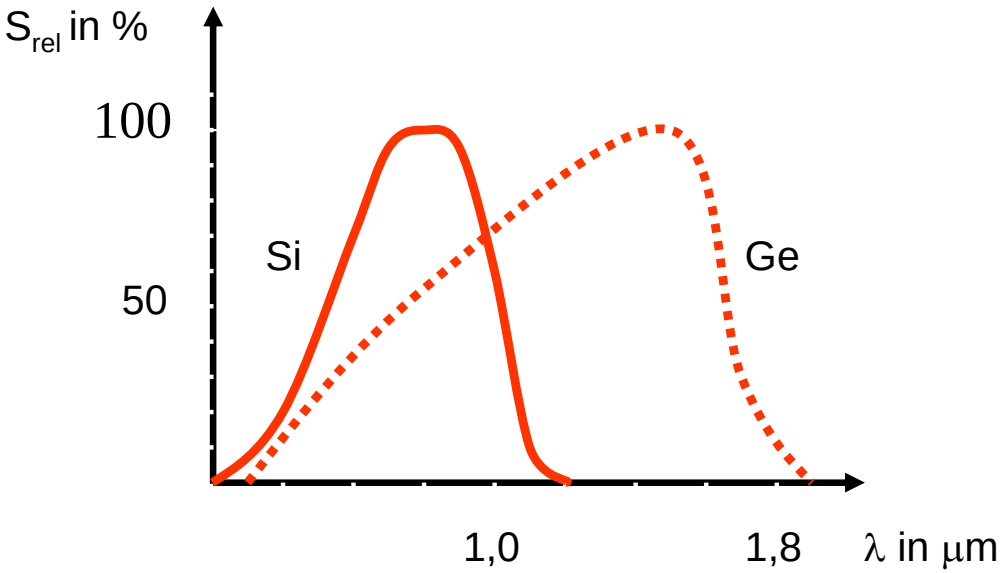
Fotodiode

Eine Fotodiode ist eine Halbleiterdiode deren pn-Übergang dem Licht gut zugänglich ist. Sie wird in Sperrichtung betrieben. Die Größe des Sperrstroms ist linear Abhängig von der Beleuchtungsstärke. Bei Lichteinfall werden Elektronen aus ihren Bindungen gelöst. Es entsteht ein freies Elektron und ein Loch. Die Ladungsträger werden aus der Sperrschicht hinaus beschleunigt.



Fotodiode

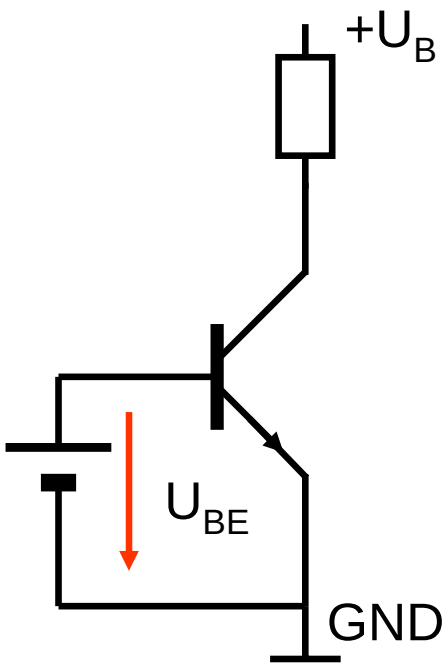




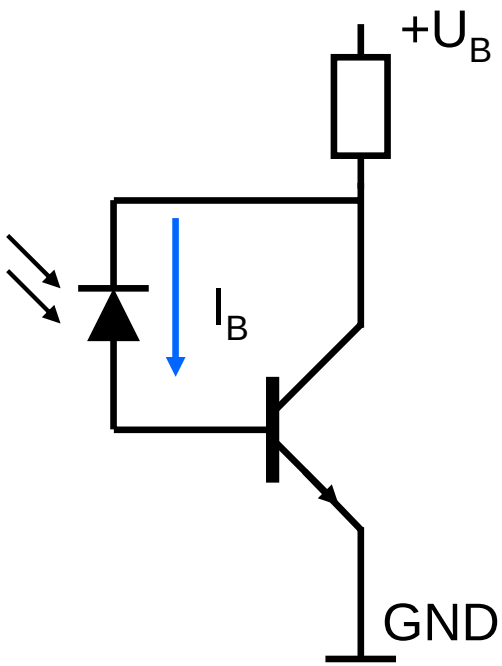
Kennwerte einer Leuchtdiode:

- Fotoempfindlichkeit — E ≈ 120nA/lx
- Wellenlänge der maximalen Empfindlichkeit — λ_{ES} ≈ 0,85 µm
- Grenzfrequenz — f_{gr} ≈ 1 MHz
- Sperrschichtkapazität — C_S ≈ 20..150 pF
- Dunkelstrom — I_d ≈ 500 nA

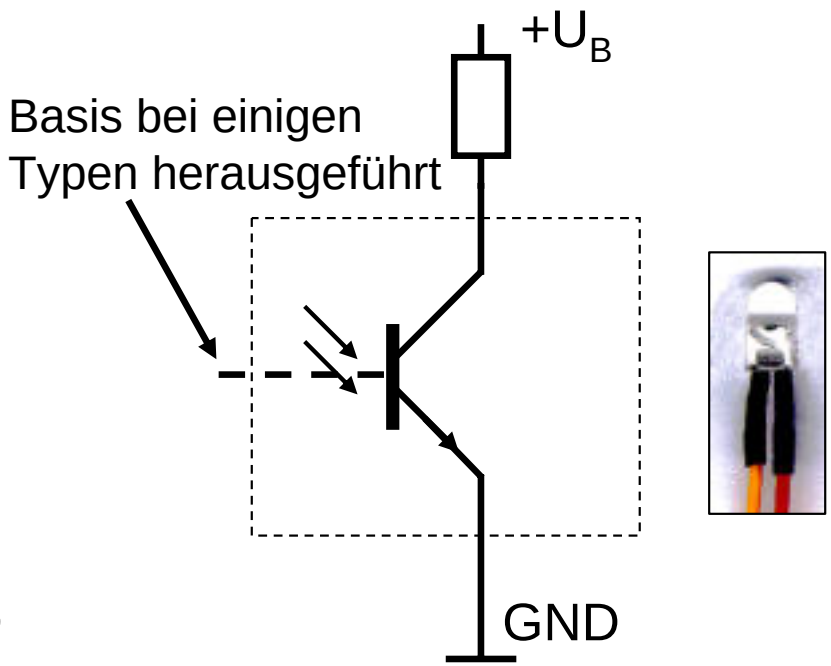
Fototransistor



Ersatzschaltung des Fototransistors mit einem Fotoelement



Ersatzschaltung des Fototransistors mit einer Fotodiode



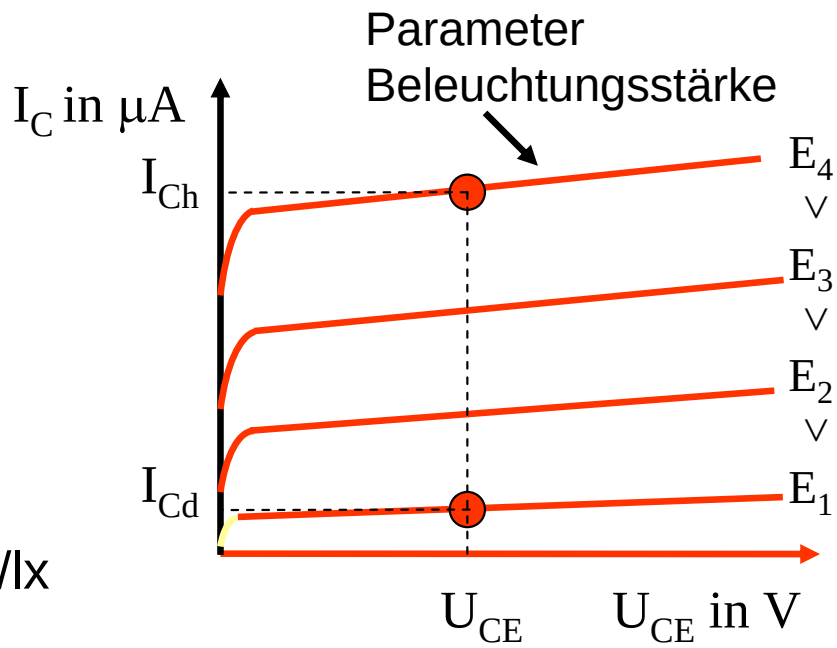
Symbol des Fototransistors

Fototransistor

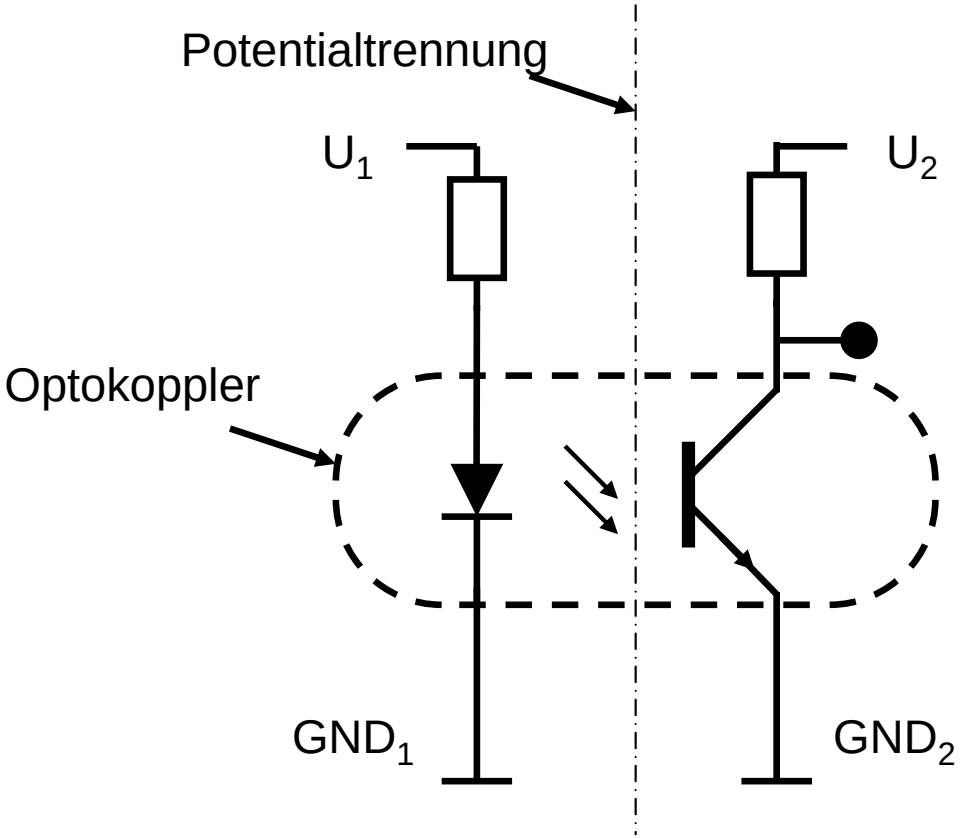
Fototransistoren sind spezielle Transistoren bei denen Licht auf die Kollektor-Basis Sperrschicht fallen kann.
Bei einigen Fototransistoren ist die Basis zur Einstellung des Arbeitspunktes herausgeführt.

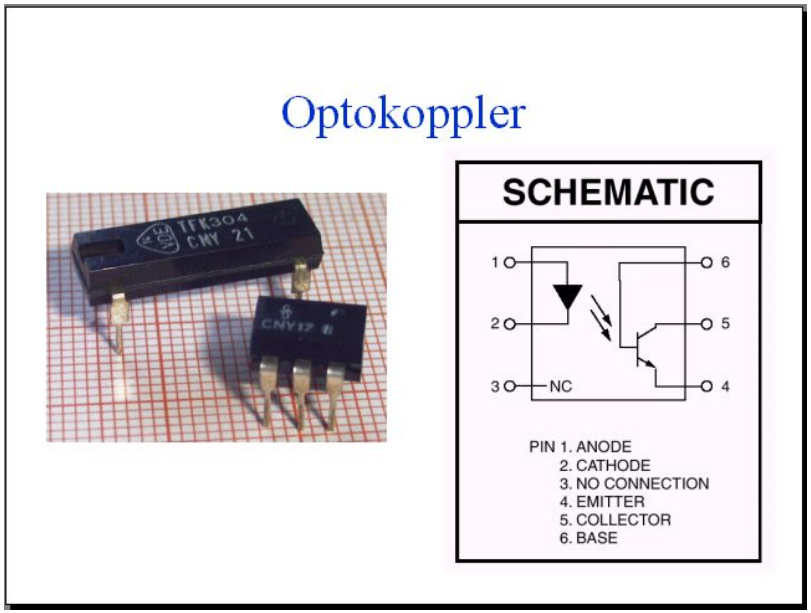
Kenngrößen:

- Kollektorhellstrom $I_{ch} \approx$ ... mA
- Kollektordunkelstrom $I_{cd} \approx$ ... µA
- Wellenlänge der max. Empfindlichkeit $\lambda_{ES} \approx 0{,}8$ µm
- Fotoempfindlichkeit $E \approx 0{,}15$ µA/lx



Optokoppler





Ein Optokoppler in der gezeigten Schaltung wirkt wie ein Negator.
Bei $U_1=U_2=5V$ beträgt die Spannung am Punkt Y Null Volt.

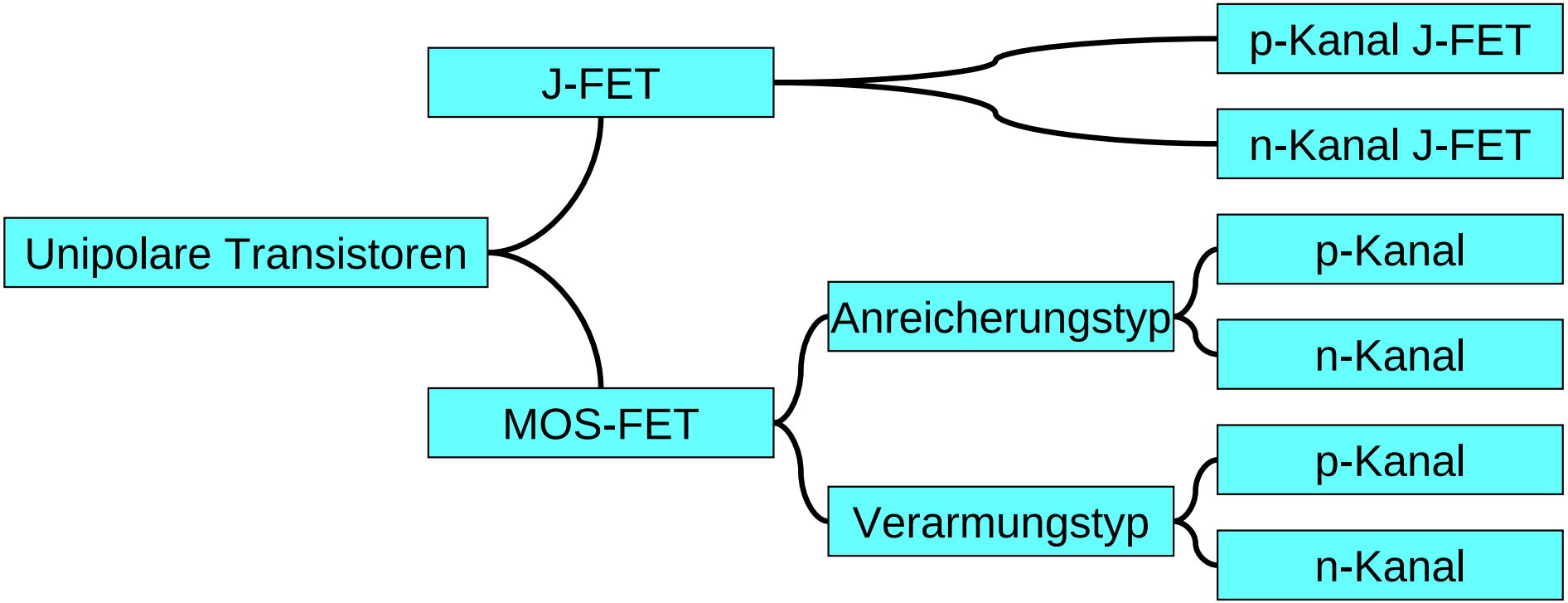
Unipolare Transistoren

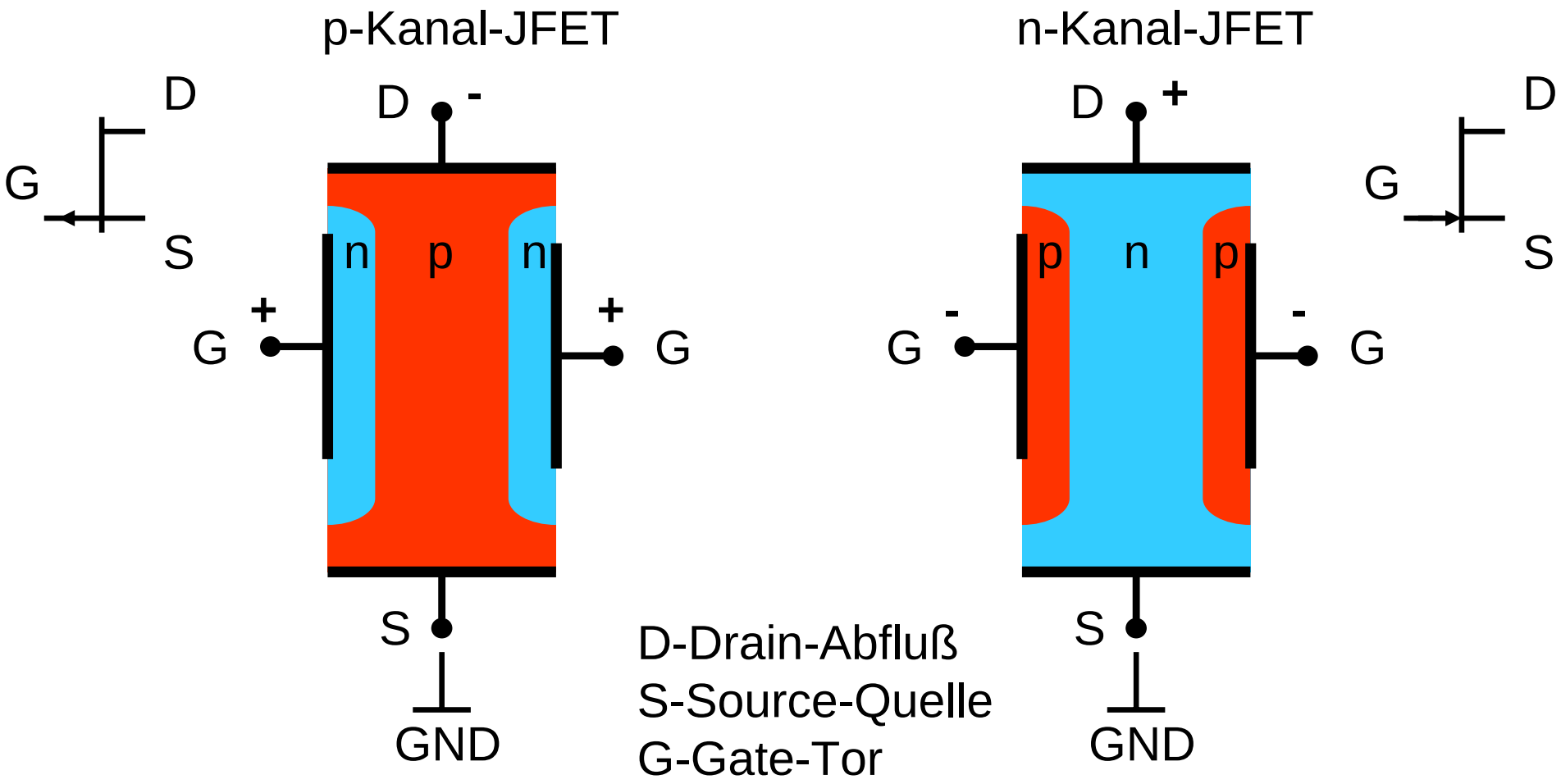
J-FET
Sperrschicht-Feldeffekttransistoren (J-FET)
J - Junction – Sperrschicht
FET - Feld-Effekt-Transistor

MOS-FET
Metalloxid-Feldeffekttransistoren (IG-FET)
MOS - Metall-Oxide-Semiconductor
IG - Insulated Gate

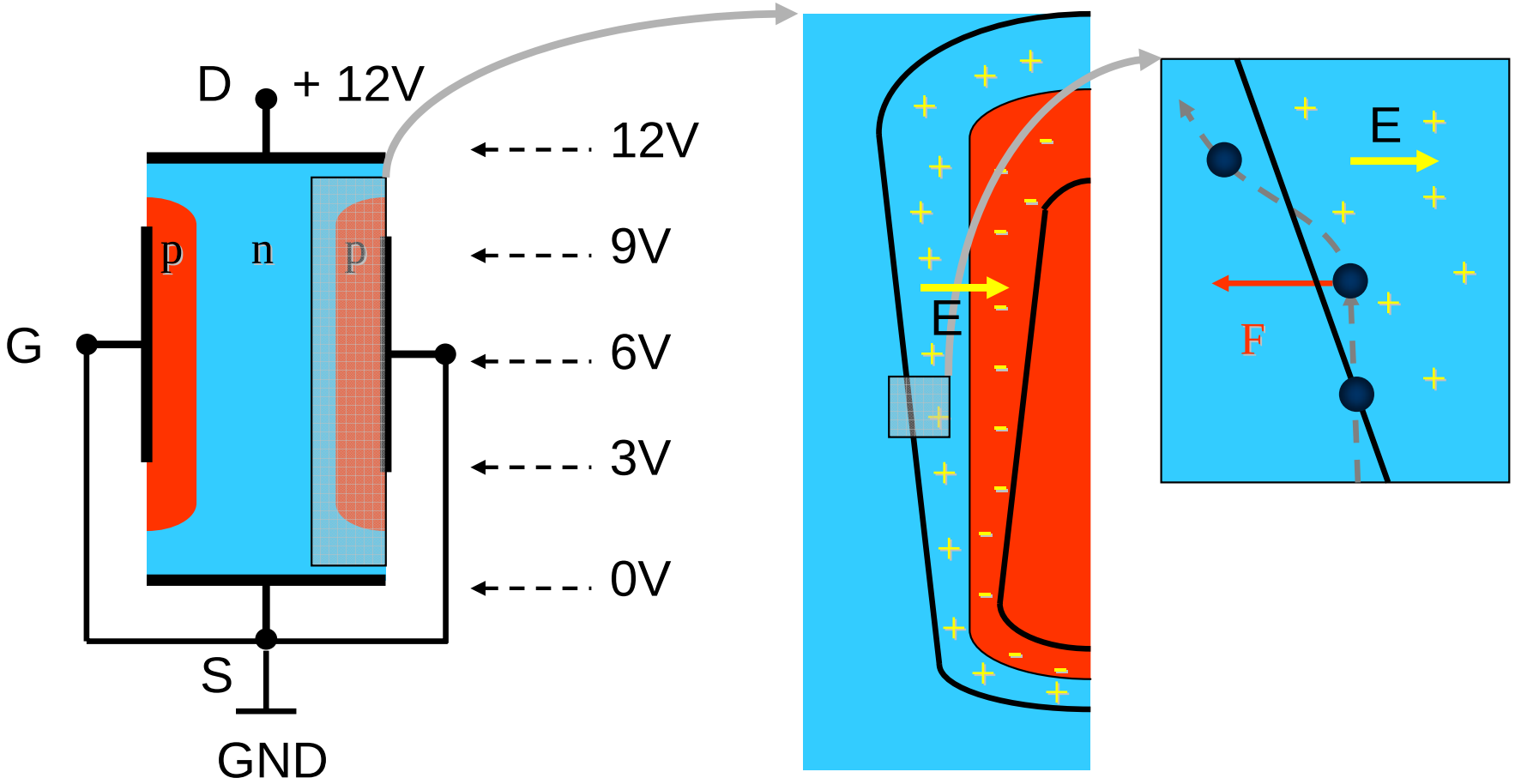
Unipolare Transistoren

Bei Unipolaren Transistoren werden die pn-Übergänge nur in einer Polarität genutzt.

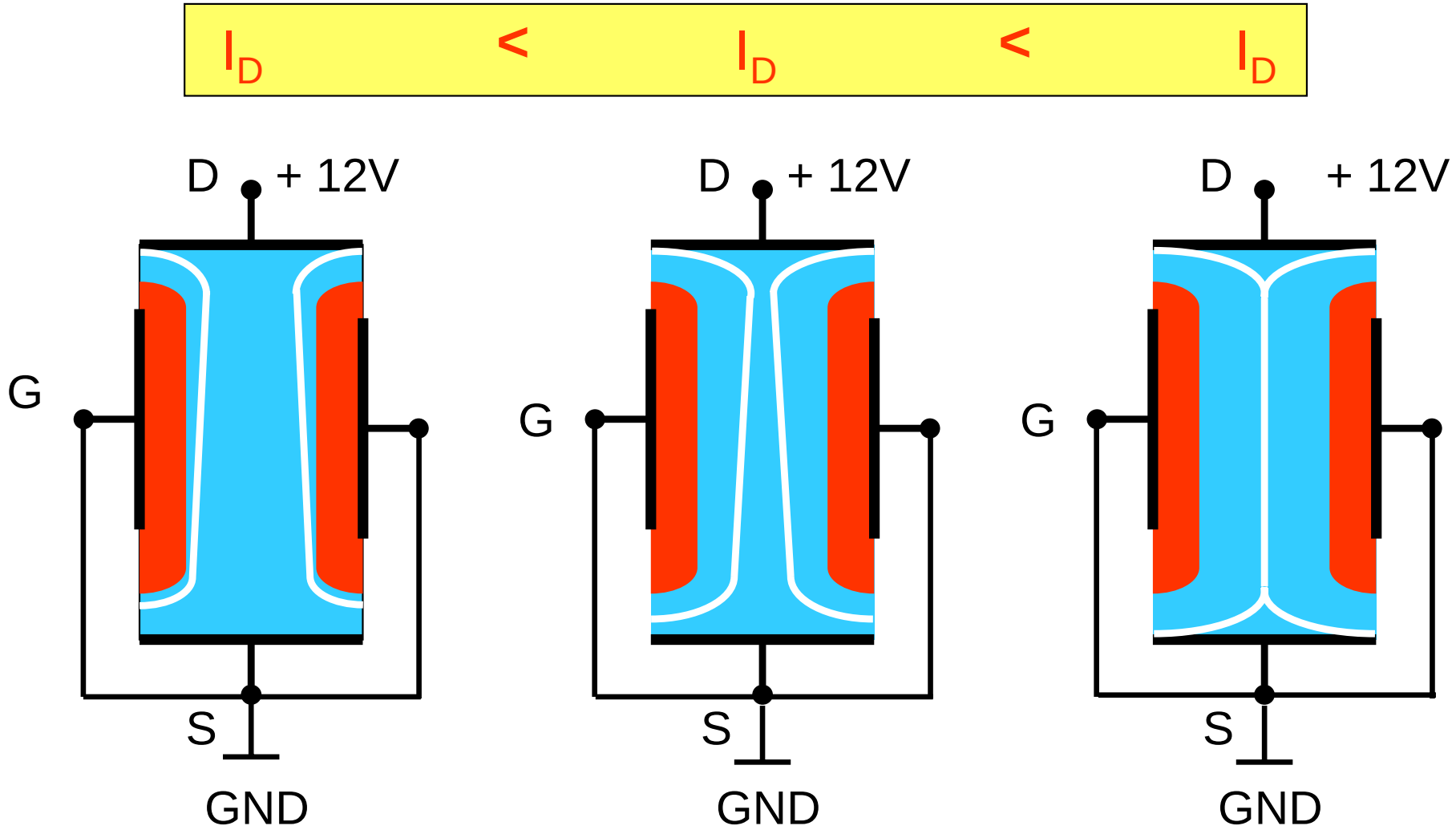



p-Kanal-JFET
n-Kanal-JFET
D
G
S
D
-
n
p
n
+
+
G
G
S
GND
D
+
p
n
p
-
-
G
G
S
GND
D
G
S
D-Drain-Abfluß
S-Source-Quelle
G-Gate-Tor

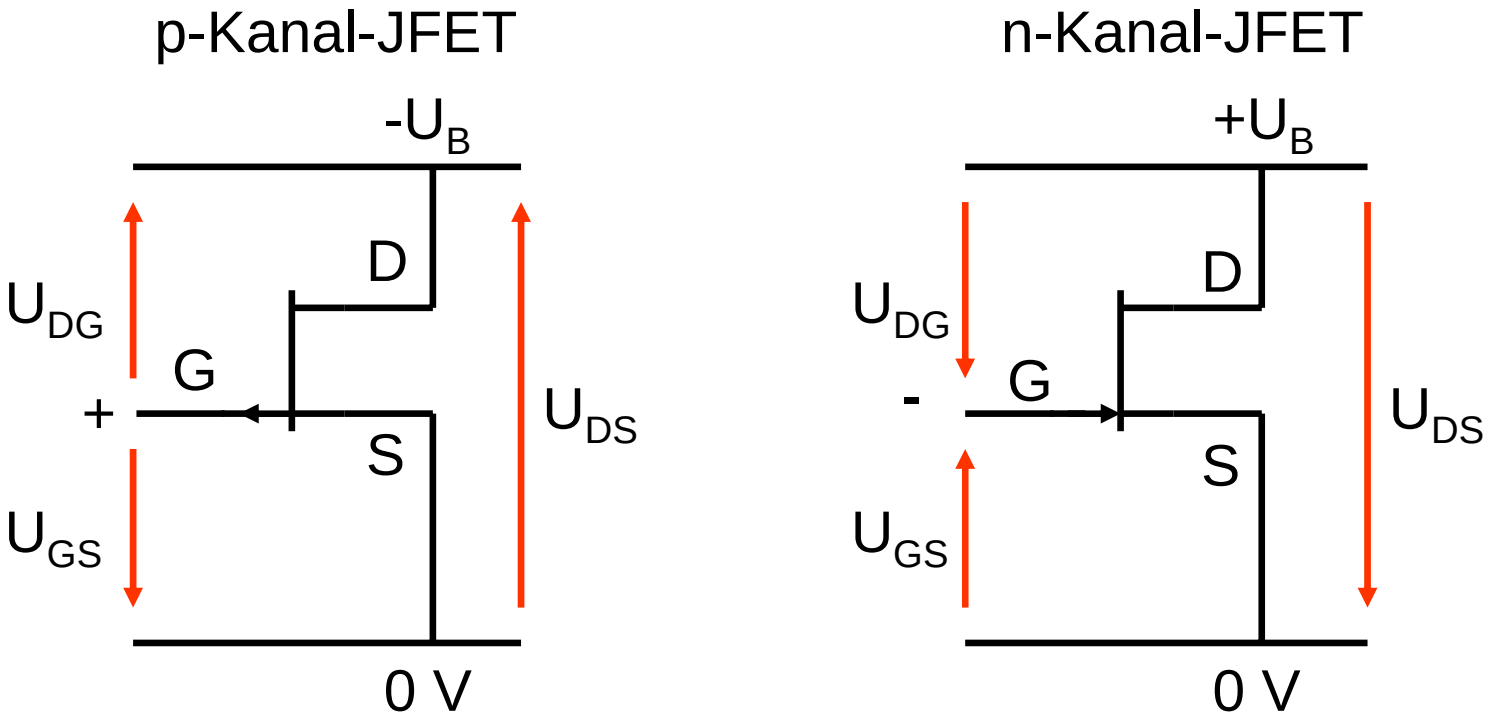
J-FET
Sperrschichten



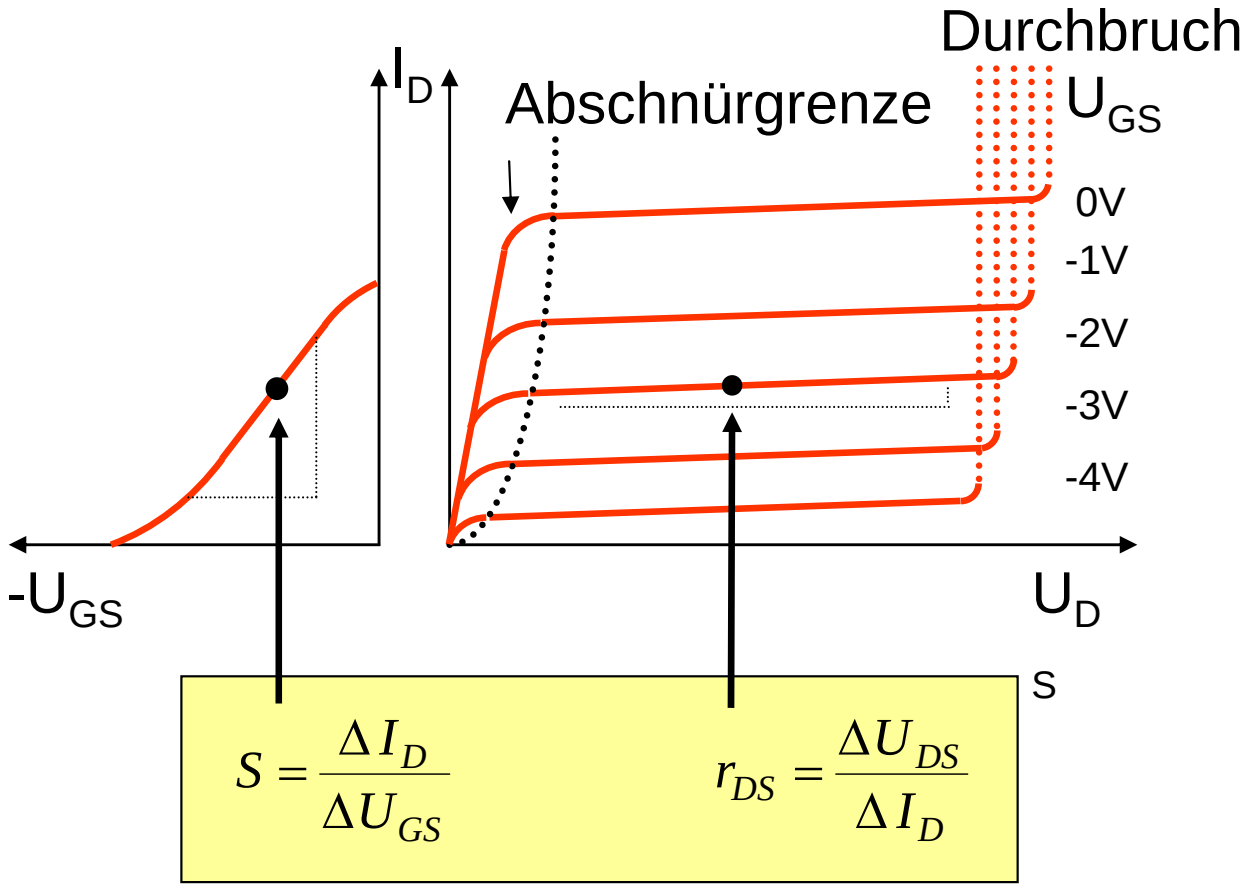
J-FET
Sperrschichten



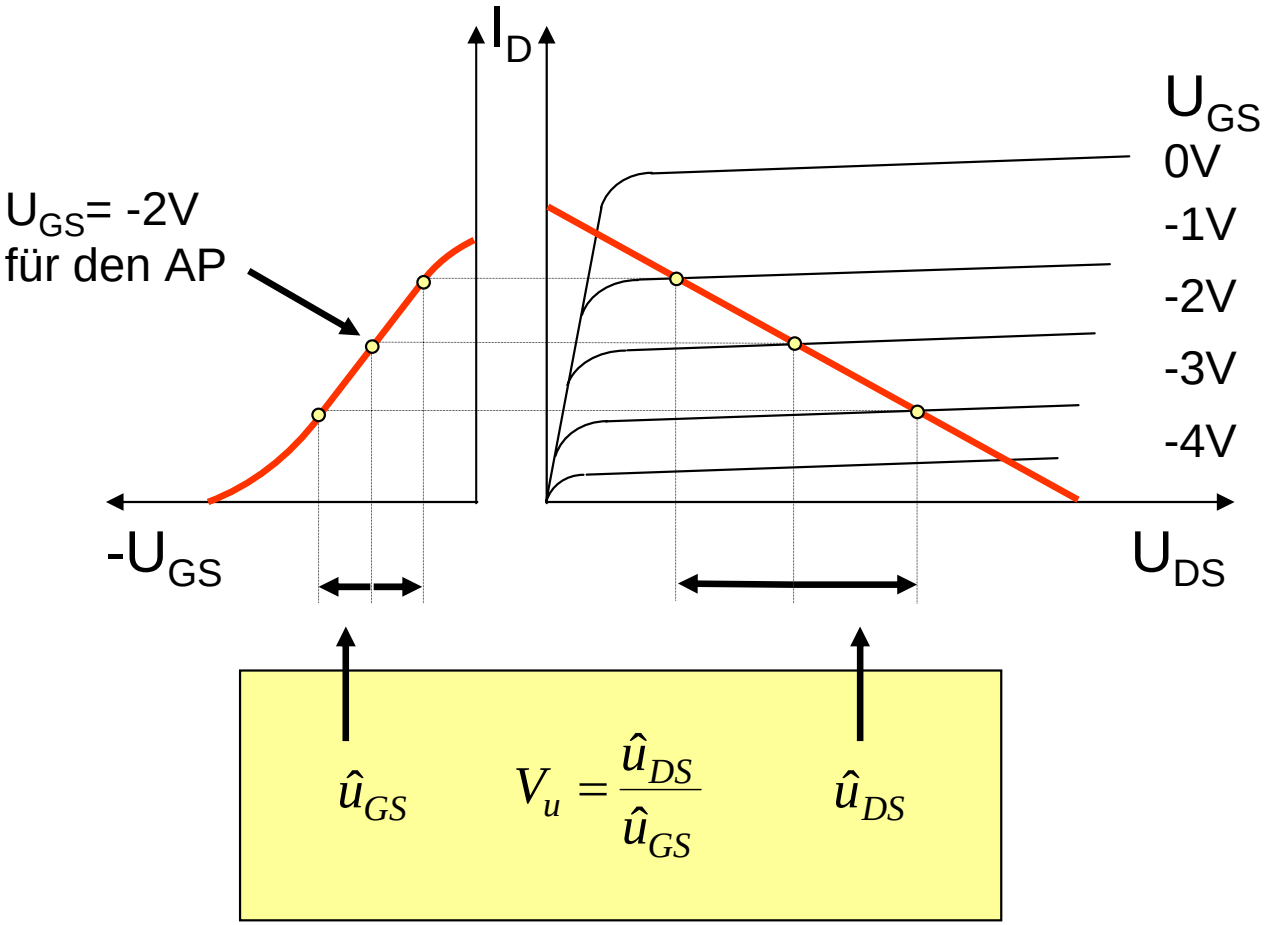
J-FET
Anschlussbelegung



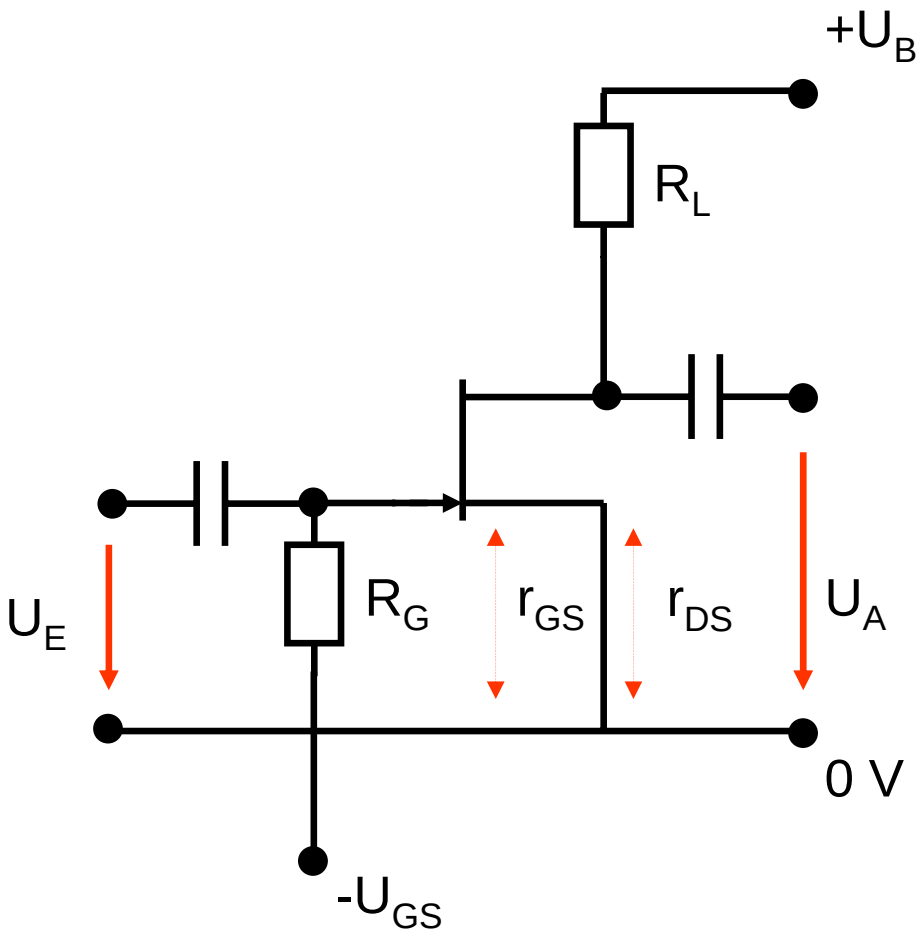
J-FET
Kennlinien



J-FET
Kennlinien Verstärker



J-FET
Verstärker



Steilheit

$$S = \frac{\Delta I_D}{\Delta U_{GS}} \qquad S = 3 - 10 \frac{mA}{V}$$

Differentieller Ausgangswiderstand

$$r_{DS} = \frac{\Delta U_{DS}}{\Delta I_D} \qquad r_{DS} = 80 - 200 k\Omega$$

Differentieller Eingangswiderstand

$$r_{GS} \approx 10^{10} - 10^{14} \Omega$$

Strom über die Sperrschichten

$$I_{Sperr} \approx 5\text{-}20 nA$$

Spannungsverstärkung

$$V_u = S \cdot \frac{R_L \cdot r_{DS}}{R_L + r_{DS}}$$

Eingangswiderstand

$$r_e = \frac{R_L \cdot r_{GS}}{R_L + r_{GS}}$$

Ausgangswiderstand

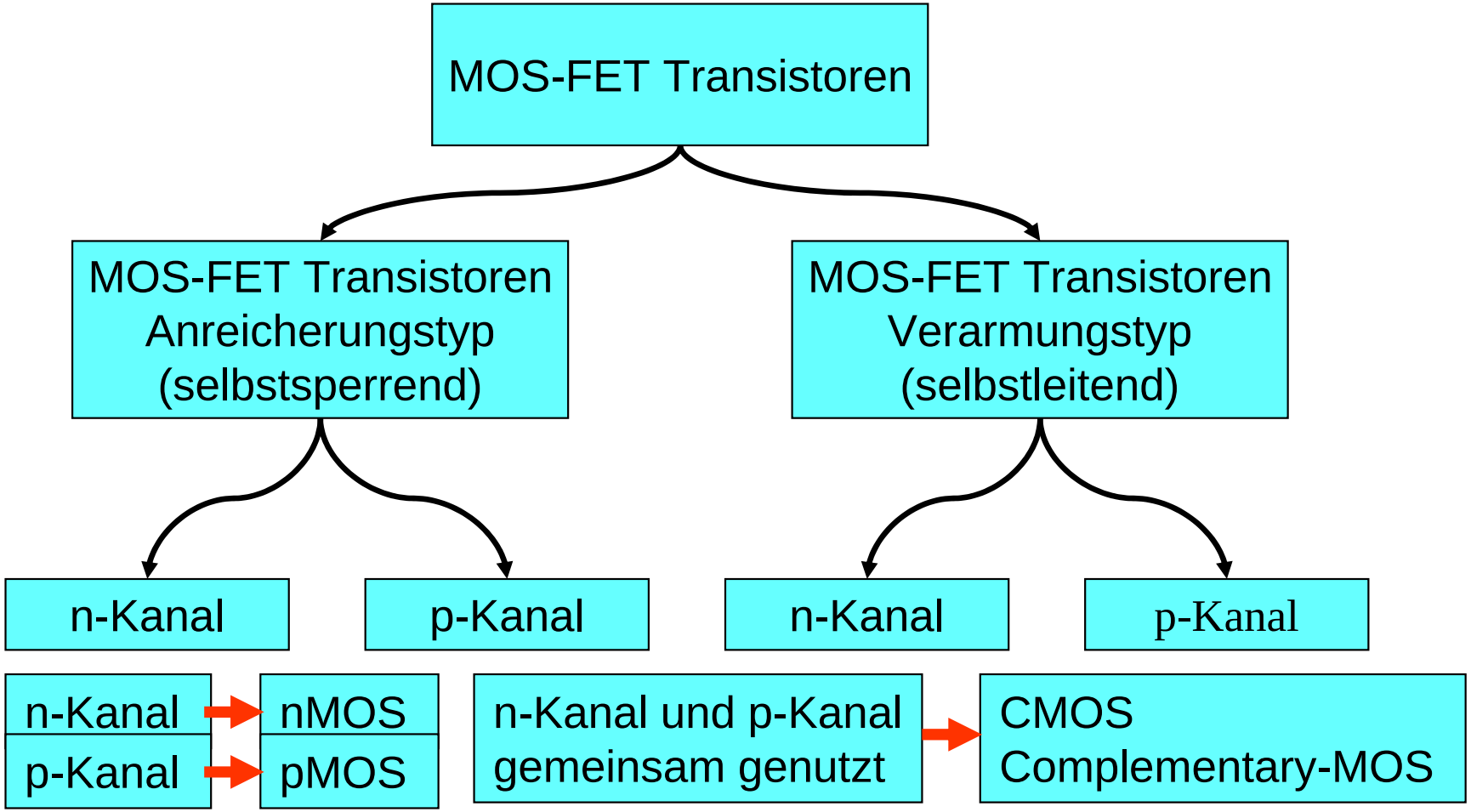
$$r_a = \frac{R_L \cdot r_{DS}}{R_L + r_{DS}}$$

Verlustleistung

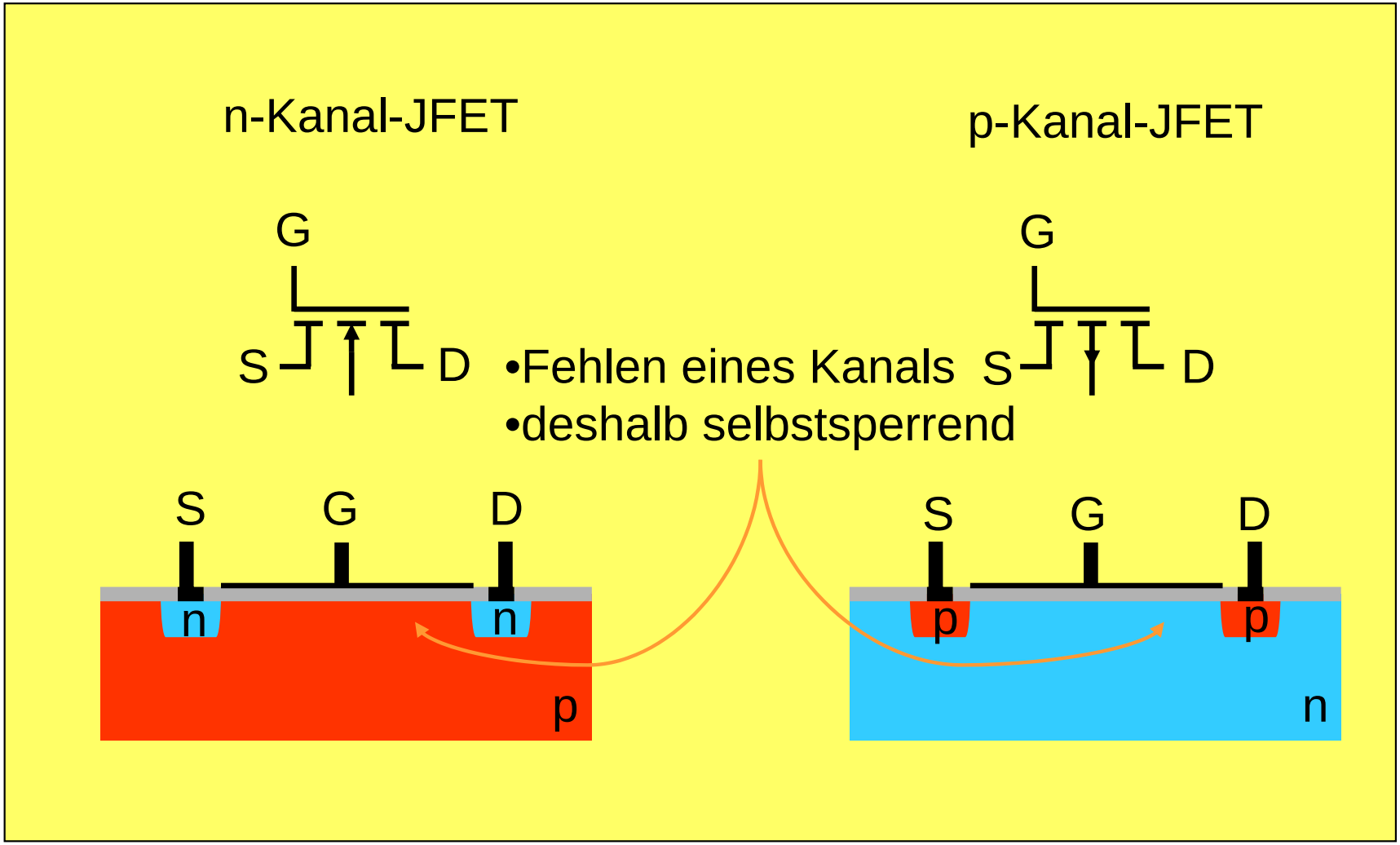
$$P_{tot} = U_{DS} \cdot I_D$$

J-FET
Grenzwerte

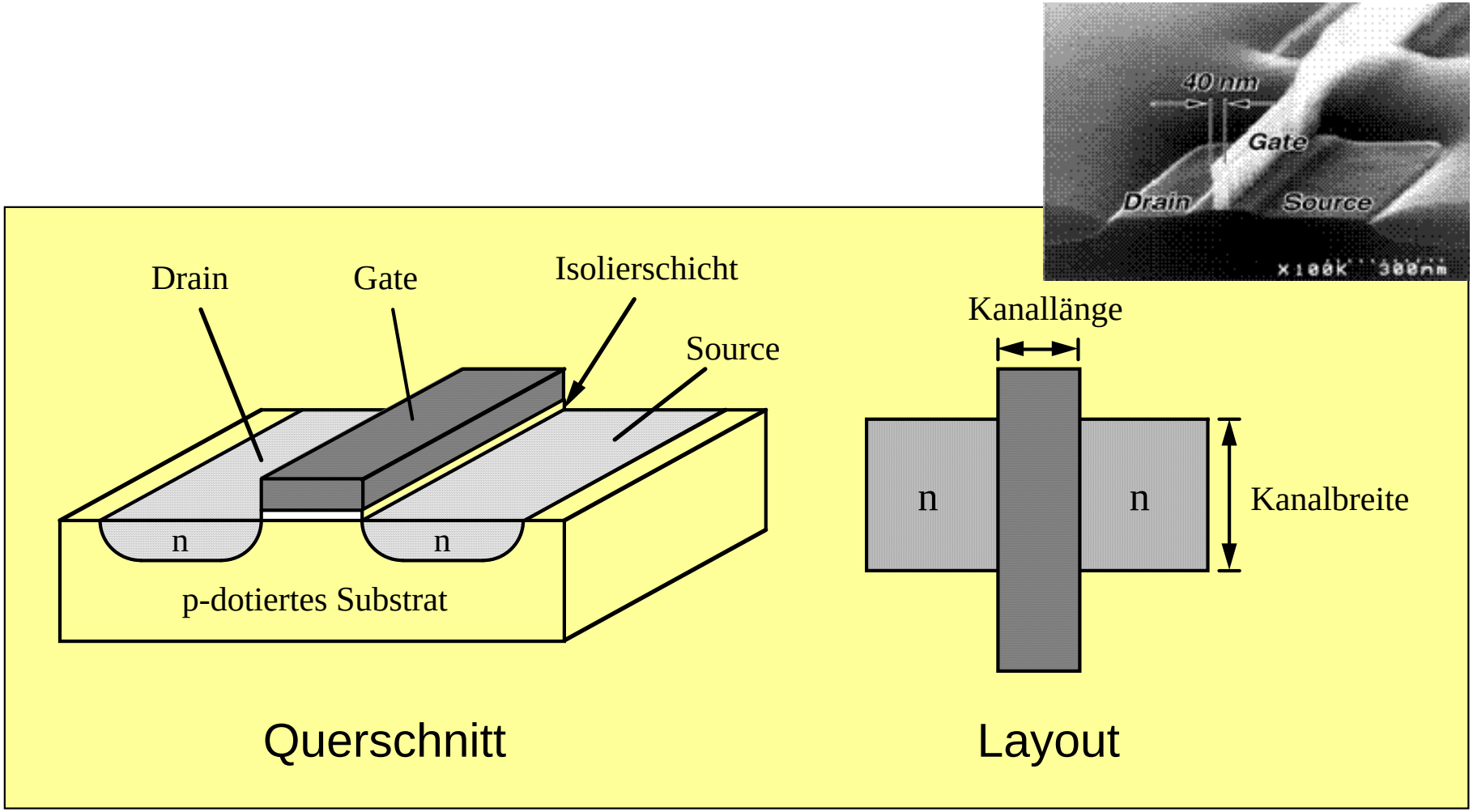
$$U_{DS\max} \approx 30V$$
$$U_{GS\max} \approx -8V$$
$$I_{D\max} \approx 20mA$$
$$P_{tot} \approx 200mW$$
$$T \approx 135^{\circ}C$$


MOS-FET Transistoren
MOS-FET Transistoren Anreicherungstyp (selbstsperrend)
MOS-FET Transistoren Verarmungstyp (selbstleitend)
n-Kanal
p-Kanal
n-Kanal
p-Kanal
n-Kanal
nMOS
p-Kanal
pMOS
n-Kanal und p-Kanal gemeinsam genutzt
CMOS Complementary-MOS

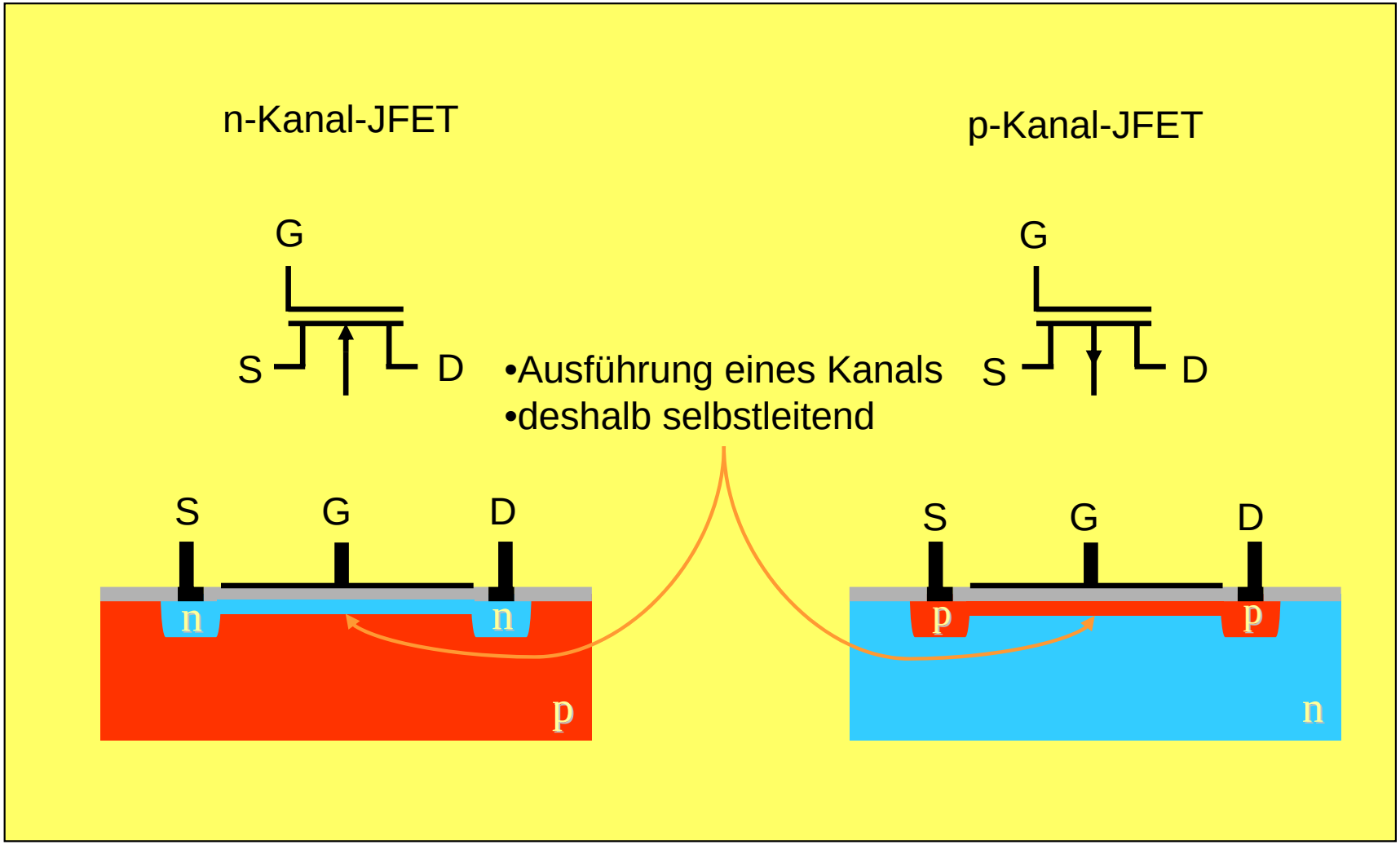
MOS-FET
Anreicherungstyp selbst sperrend



MOSFET
n-Kanal

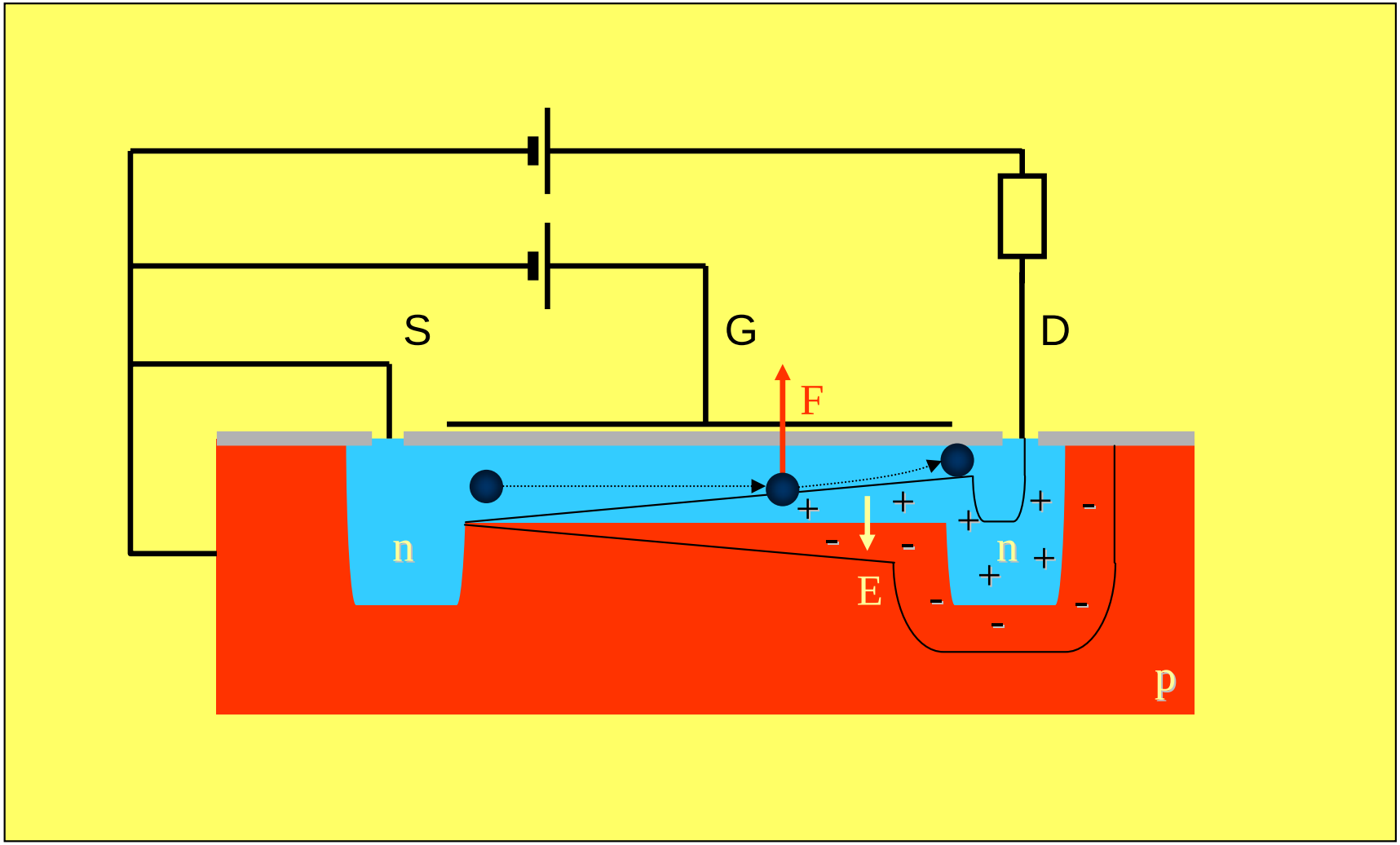


MOS-FET
Verarmungstyp selbst leitend



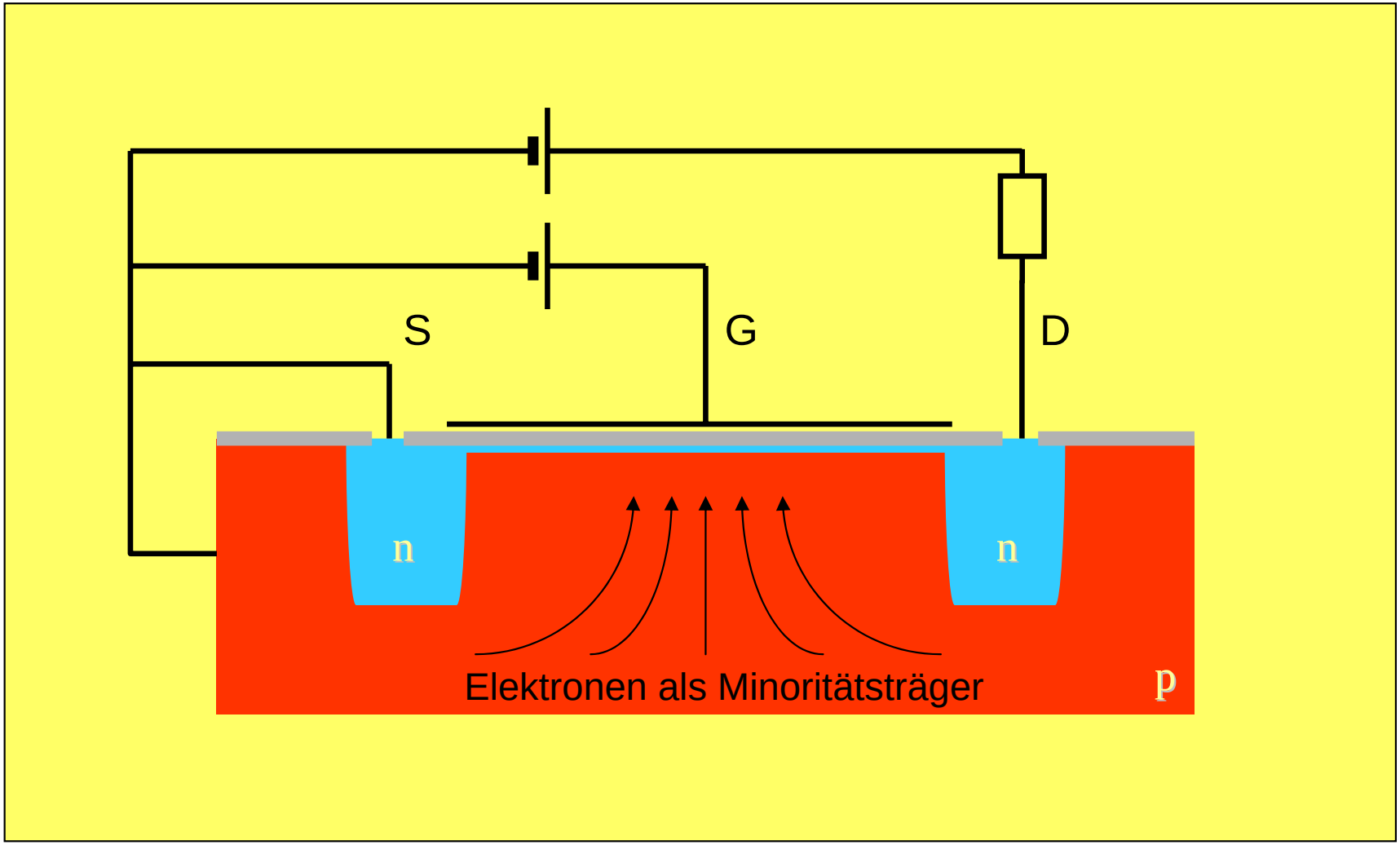
MOS-FET

Sperrschichten (n-Kanal Verarmungstyp, selbst leitend)

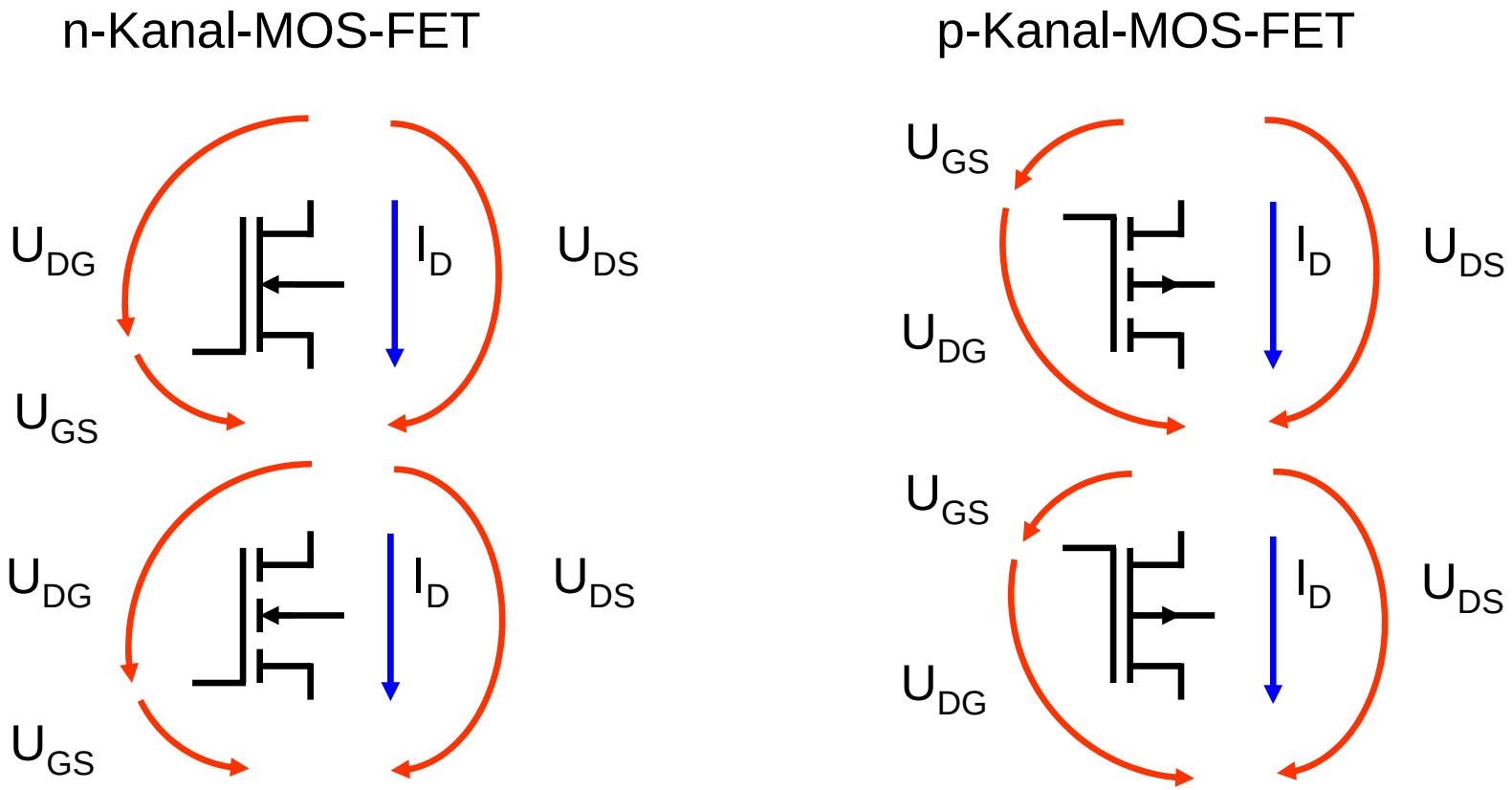


MOS-FET

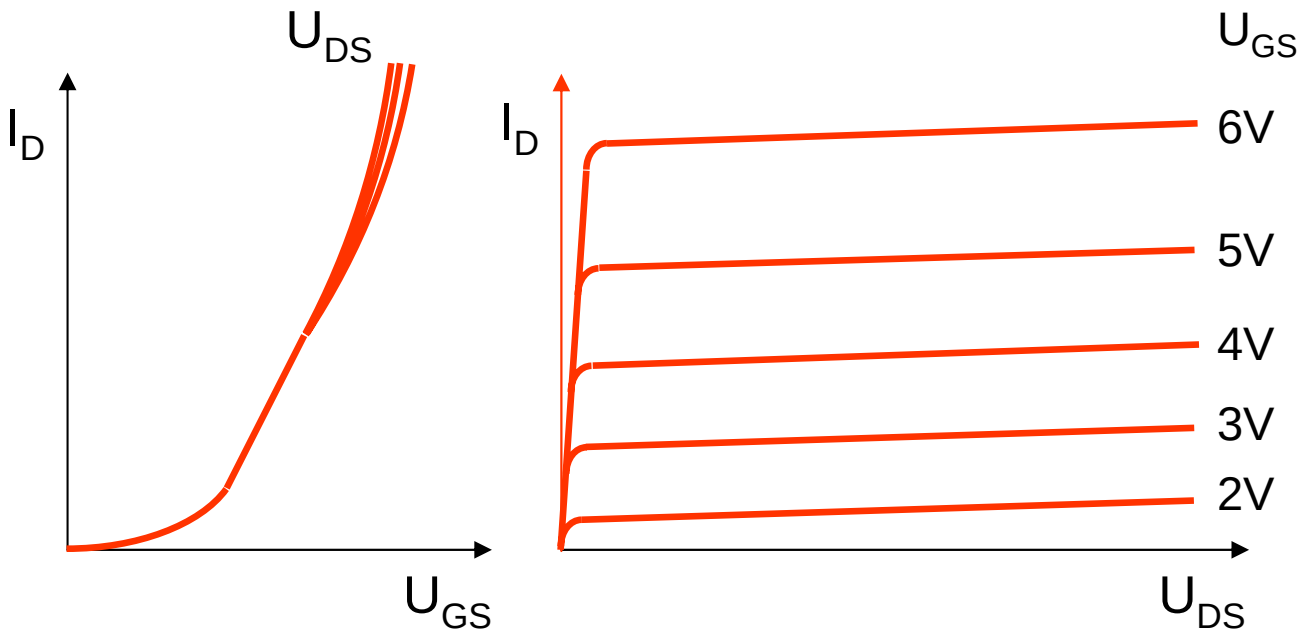
Sperrschichten (n-Kanal Anreicherungstyp, selbst sperrend)



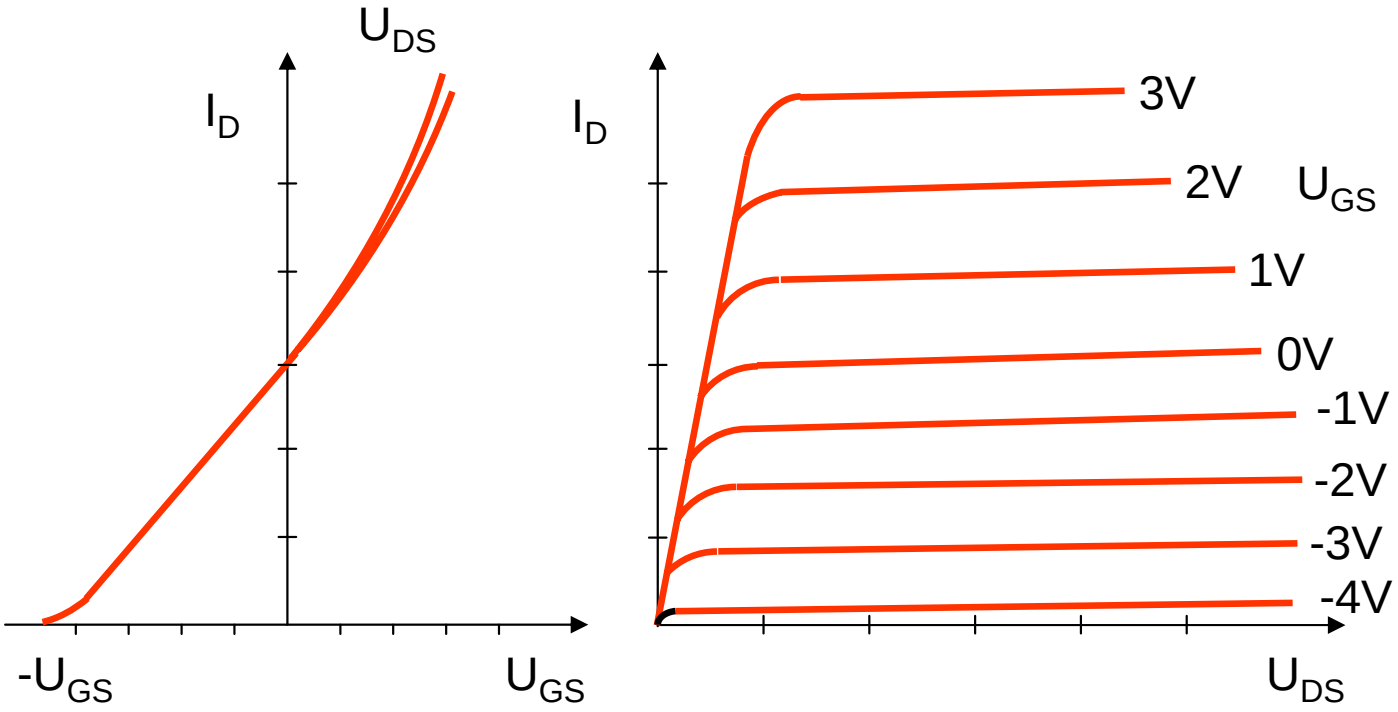
MOS-FET
Anschlussbelegung



MOS-FET
Kennlinie Anreicherungstyp n-Kanal



MOS-FET
Kennlinie Verarmungstyp n-Kanal



Freie Universität Berlin

Steilheit

$$S = \frac{\Delta I_D}{\Delta U_{GS}} \qquad S = 5 - 12 \frac{mA}{V}$$

Ausgangswiderstand

$$r_{DS} = \frac{\Delta U_{DS}}{\Delta I_D} \qquad r_{DS} = 10 - 50 k\Omega$$

Eingangswiderstand

$$r_{GS} \approx 10^{14}\Omega \qquad C_{GS} \approx 2 - 5\,pF$$

Gateleckstrom

$$I_{GSS} \approx 0{,}1\text{-}10\text{pA}$$

Spannungsverstärkung

$$V_u = S \cdot \frac{R_L \cdot r_{DS}}{R_L + r_{DS}}$$

Verlustleistung

$$P_{tot} = U_{DS} \cdot I_D$$

Durchlaßwiderstand ON

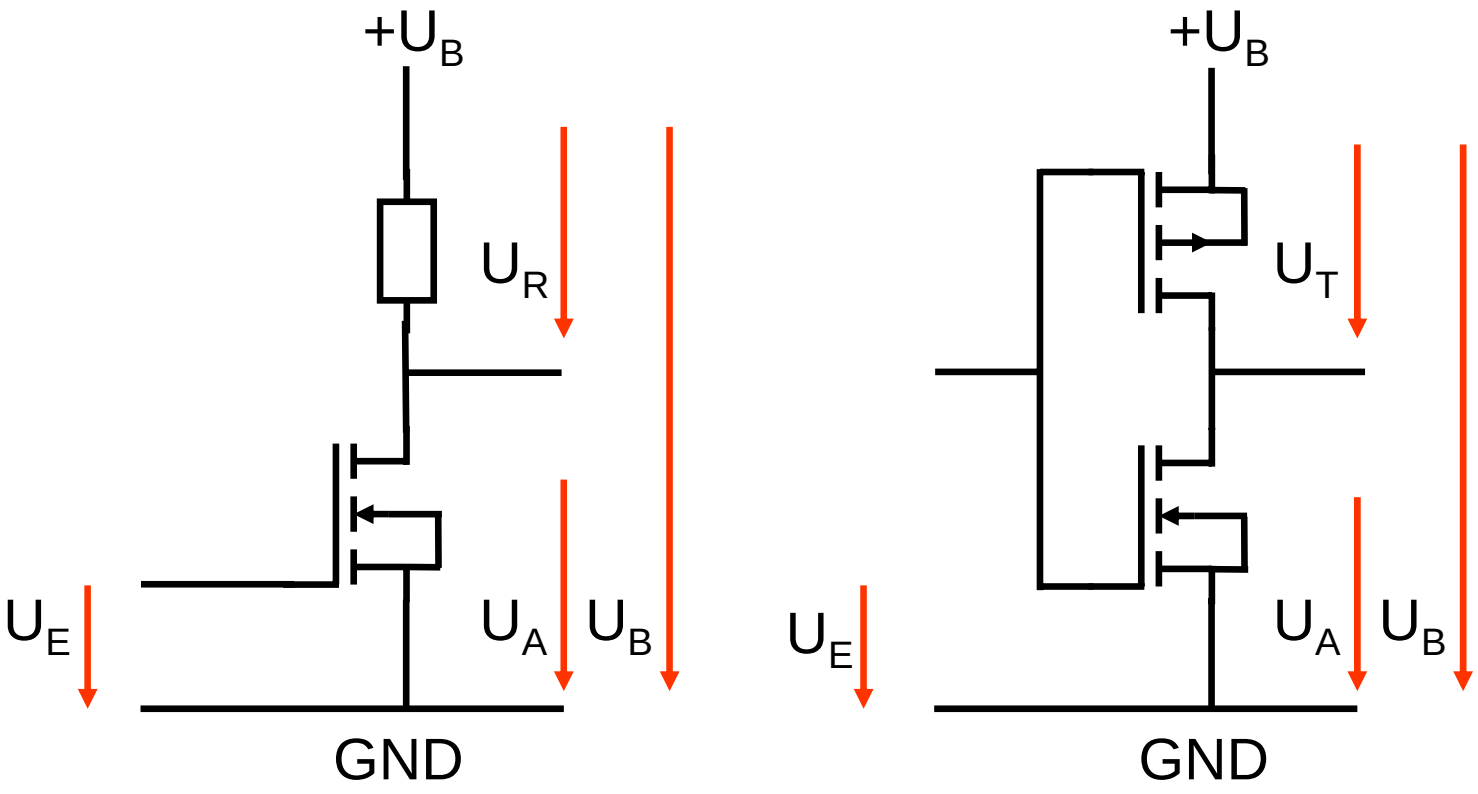
$$R_{DS_ON} \approx 200\Omega$$

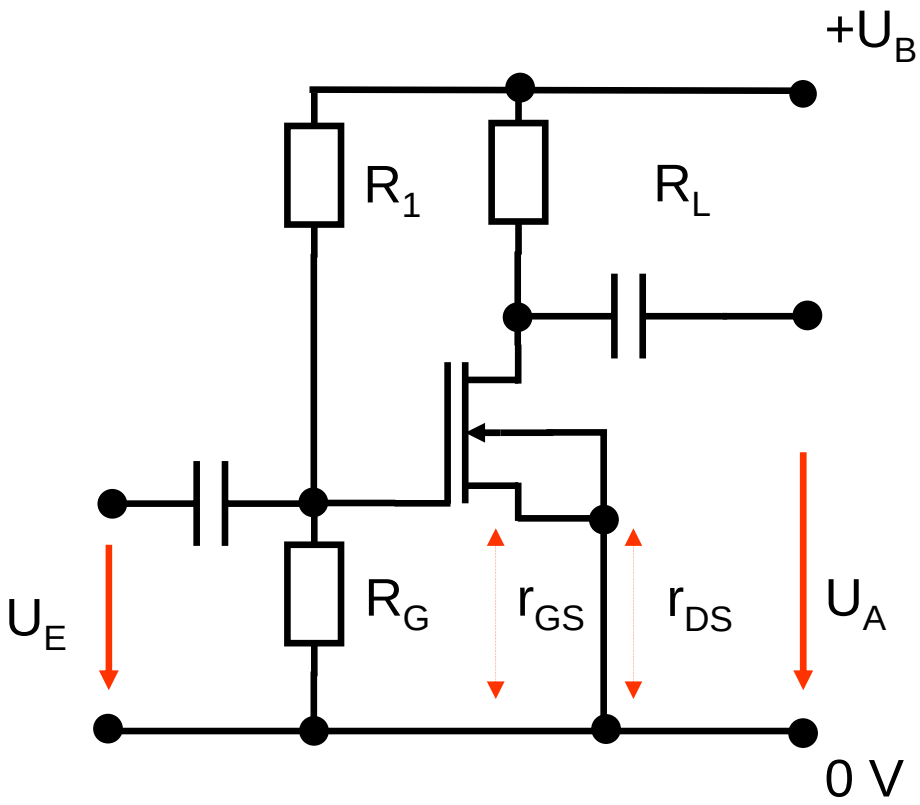
Durchlaßwiderstand OFF

$$R_{DS_OFF} \approx 10^{10}\Omega$$

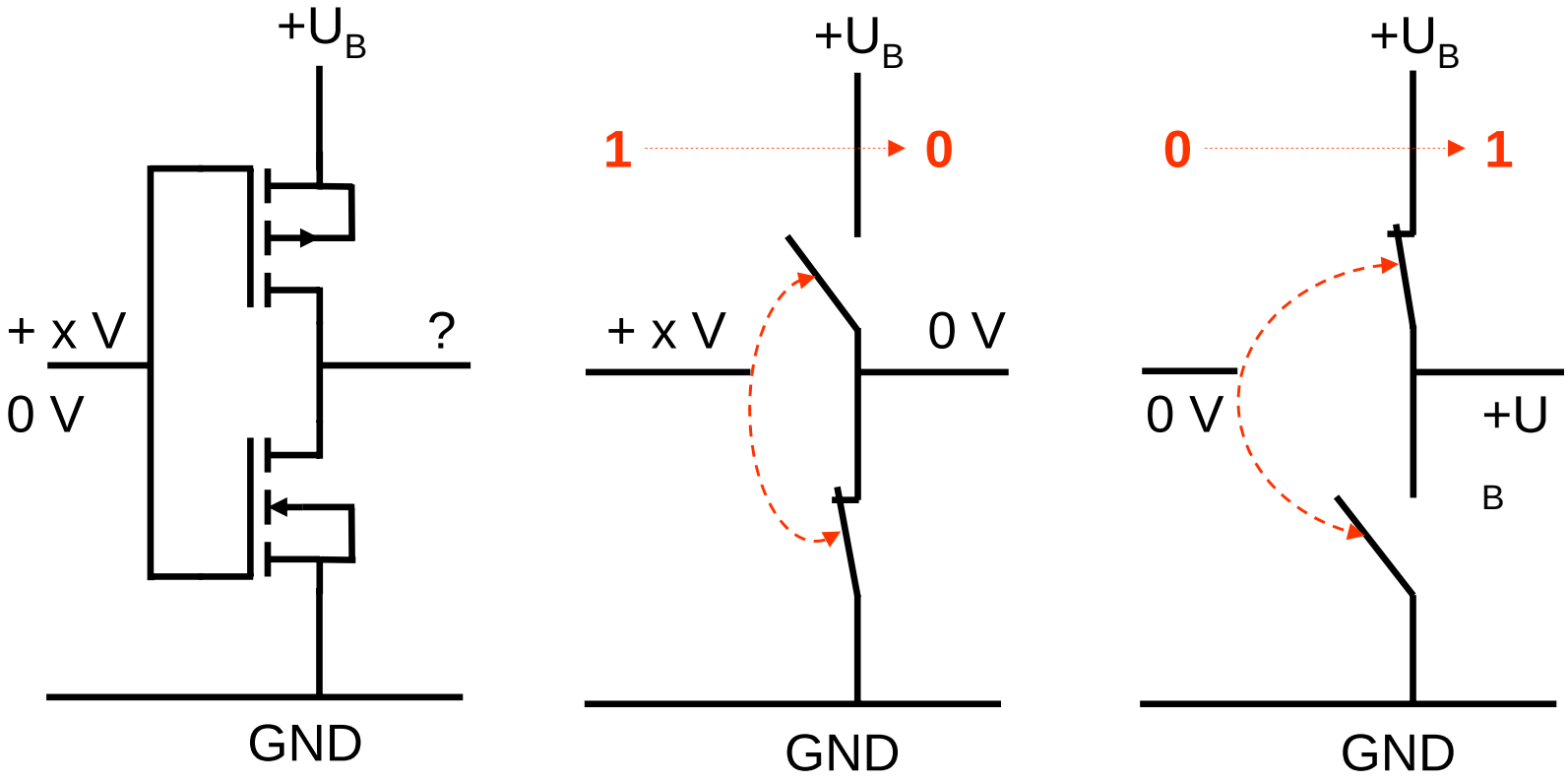
MOS-FET
Grenzwerte

$$U_{DS\max} \approx 35V$$
$$U_{GS\max} \approx \pm 10V$$
$$I_{D\max} \approx 50mA$$
$$P_{tot} \approx 150mW$$
$$T \approx 135^{\circ}C$$

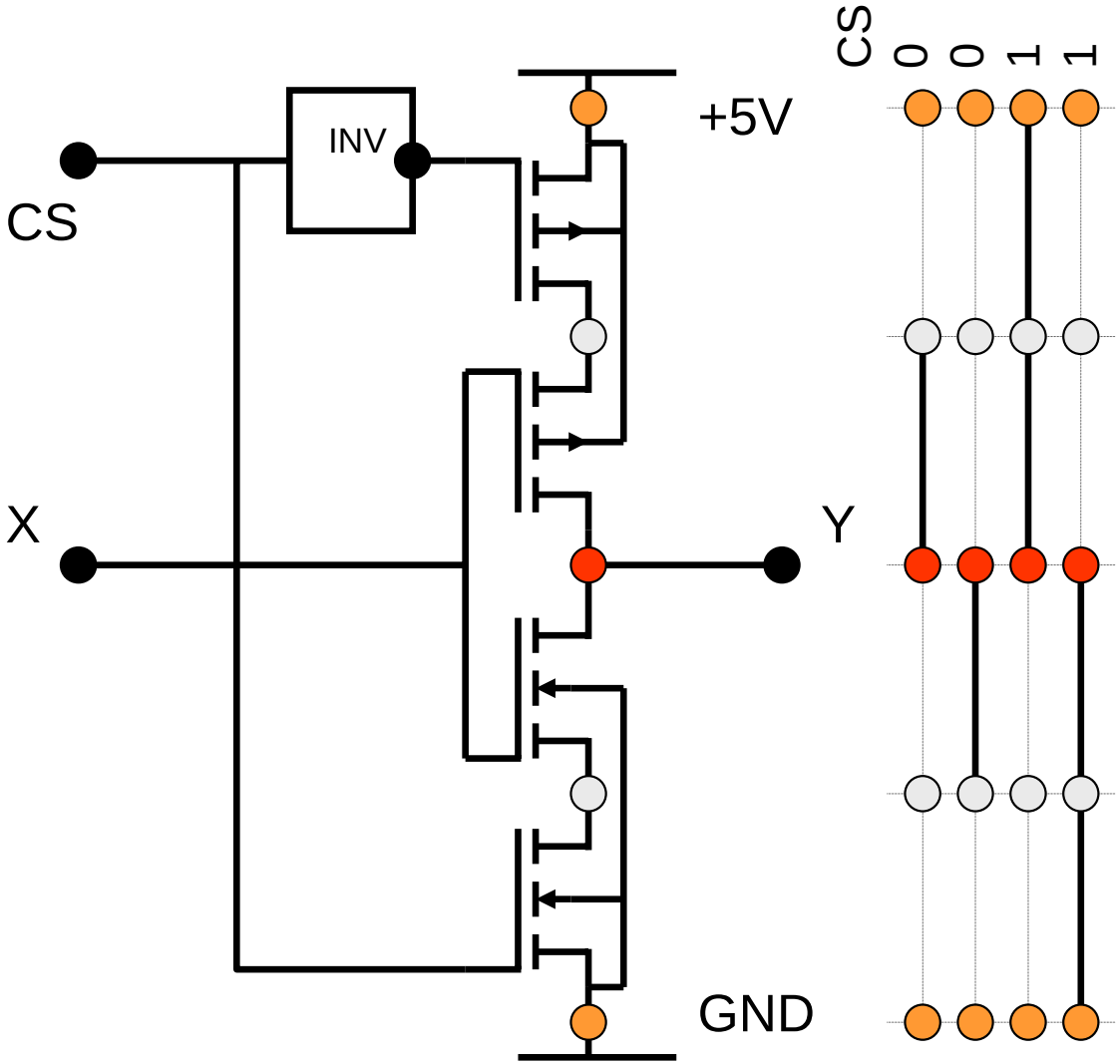

+U_B
U_R
U_E
U_A
U_B
GND
+U_B
U_T
U_E
U_A
U_B
GND


+U_B
R_1
R_L
U_E
R_G
r_GS
r_DS
U_A
0 V

MOS-FET
Inverter



MOS-FET
Tristate

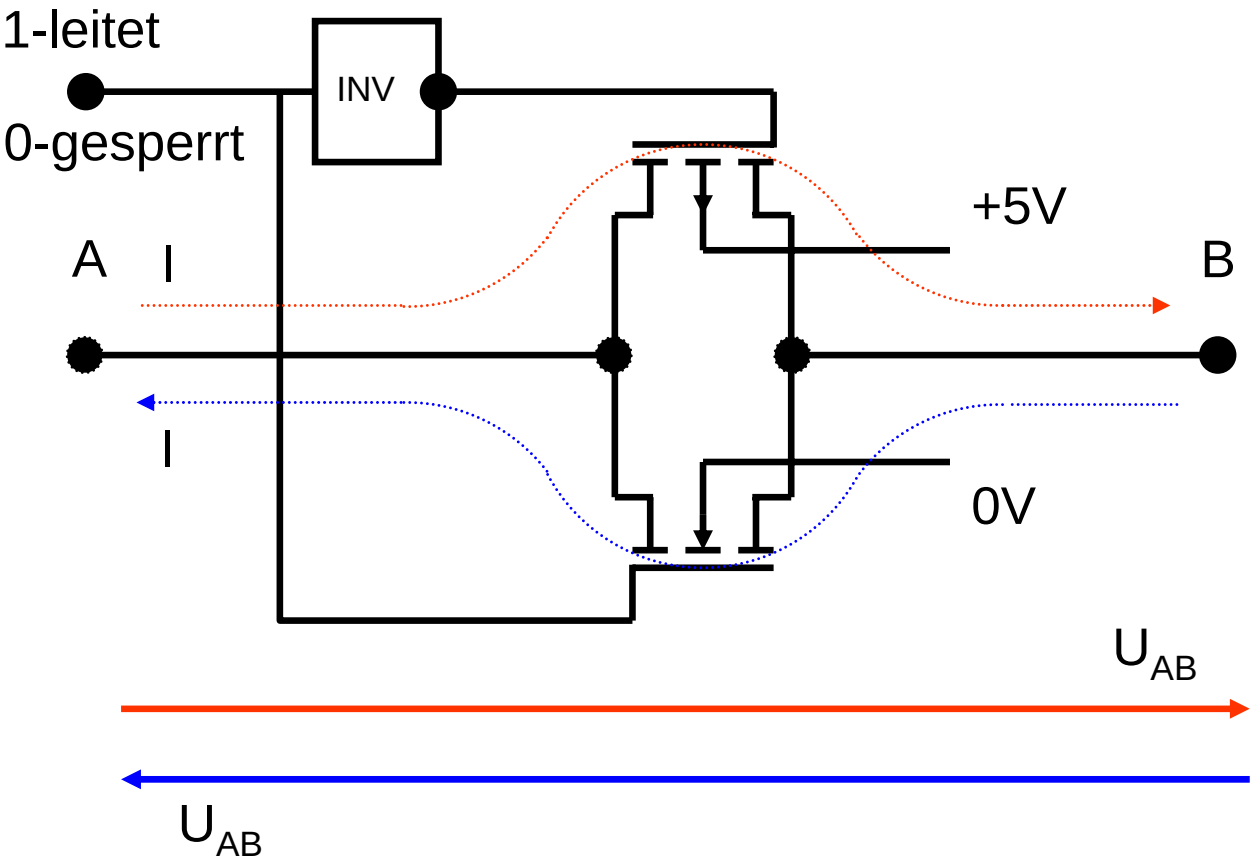


Transistor leitet

CS	X	Y
0	0	x
0	1	x
1	0	1
1	1	0

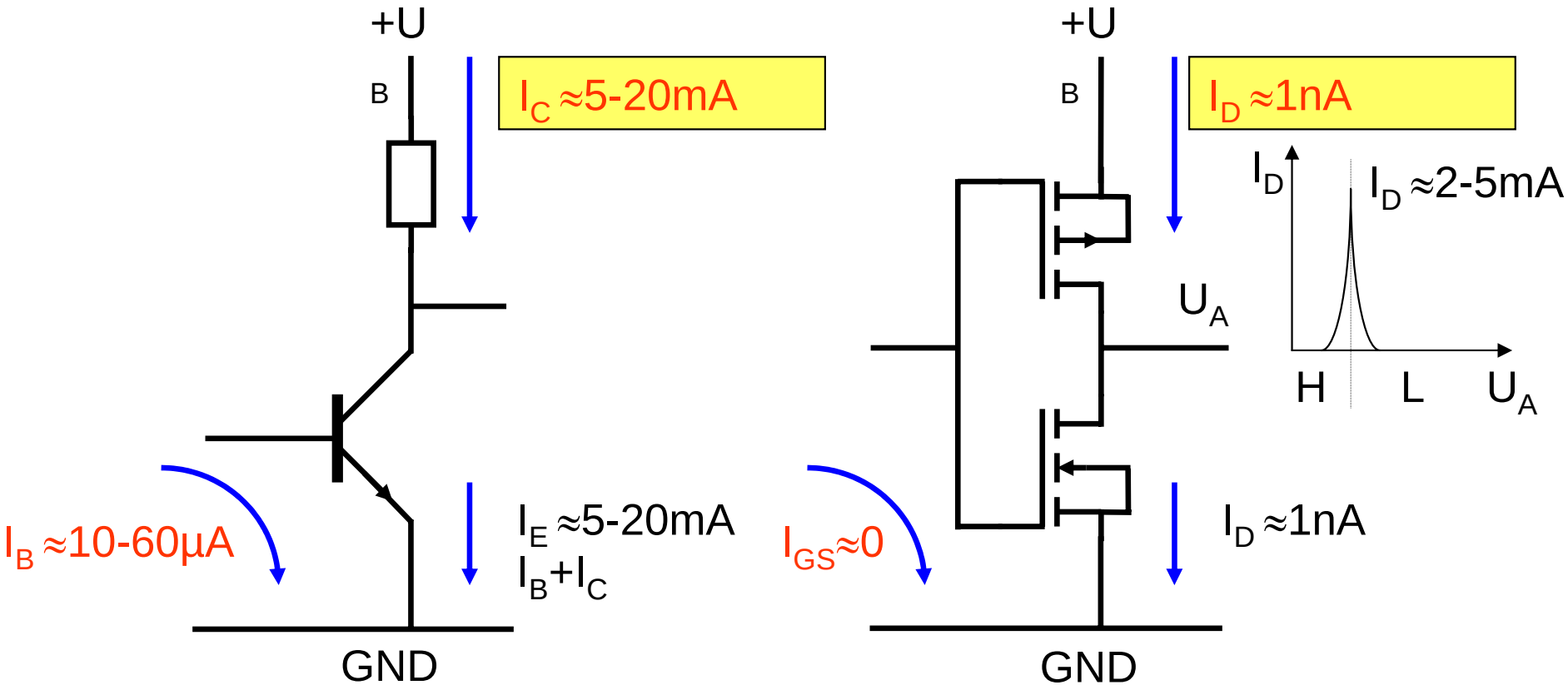
X steht für hochohmig.
Beide äußeren Transistoren sperren sind also hochohmig

MOS-FET
Transmissionsgatter



Transistorschalter

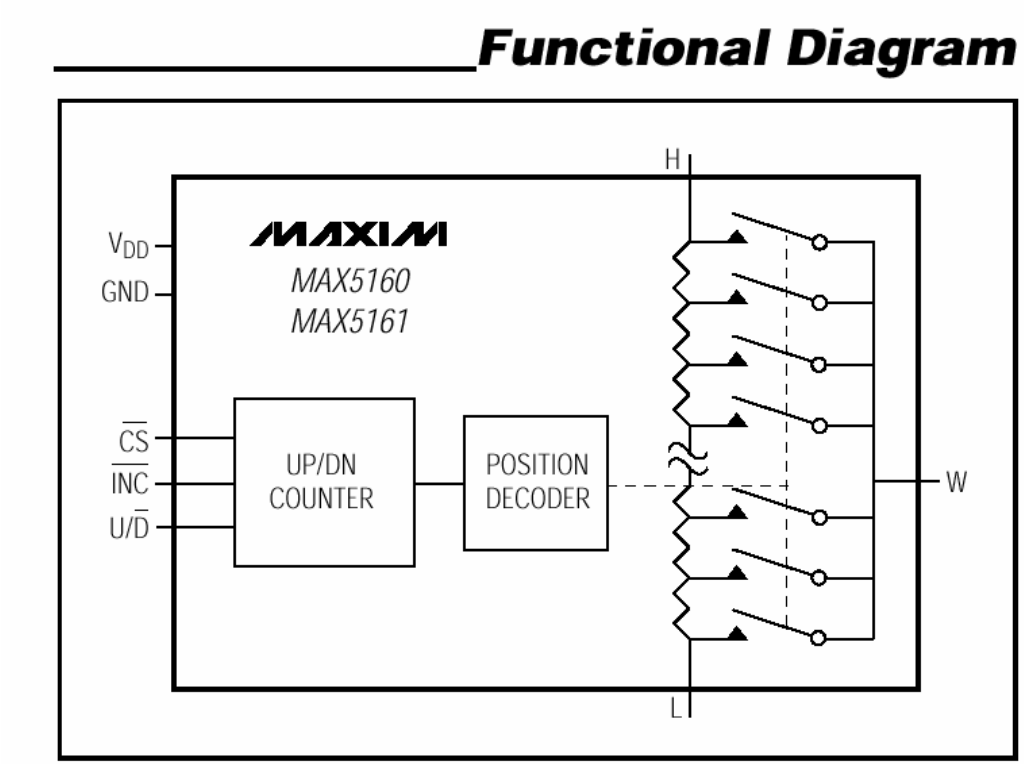
npn-Transistor und MOS-FET im Vergleich



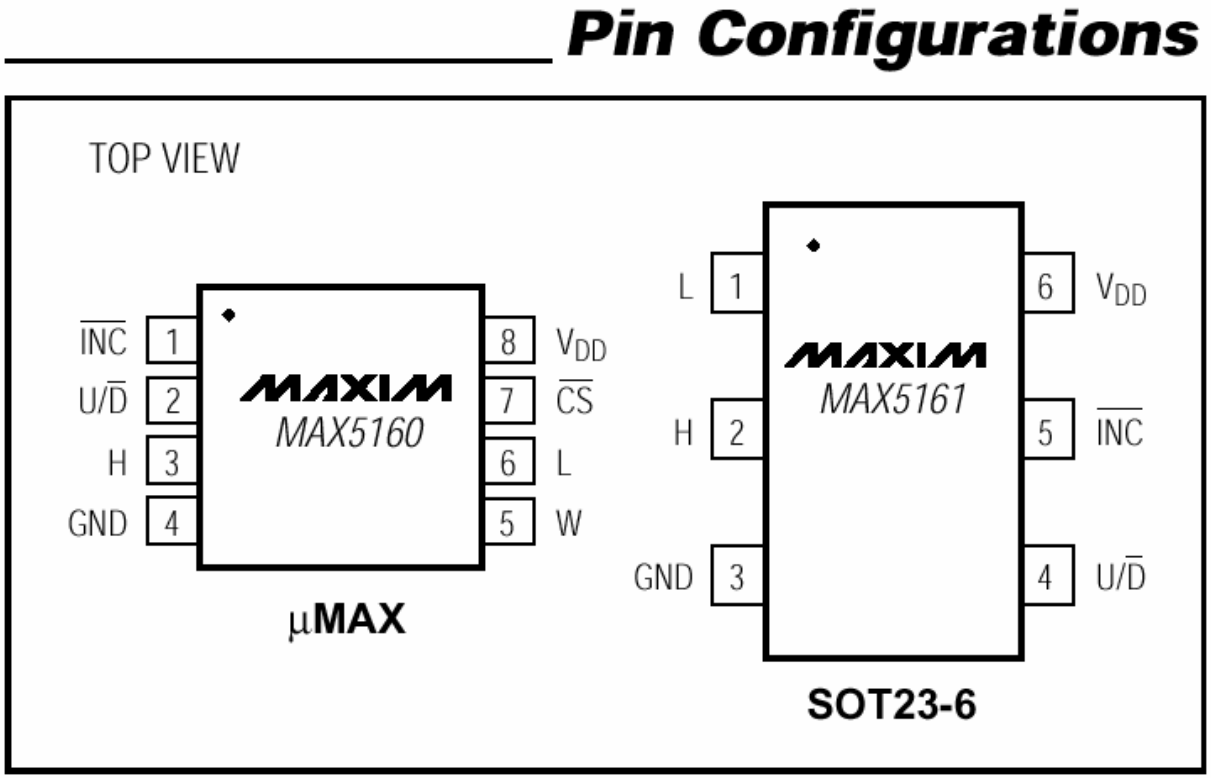
MOS-FET
Anwendungsgebiete

- Logikschaltkreise
- Operationsverstärker
- Analogschalter
- Analogmultiplexer
- Halbleiterrelais

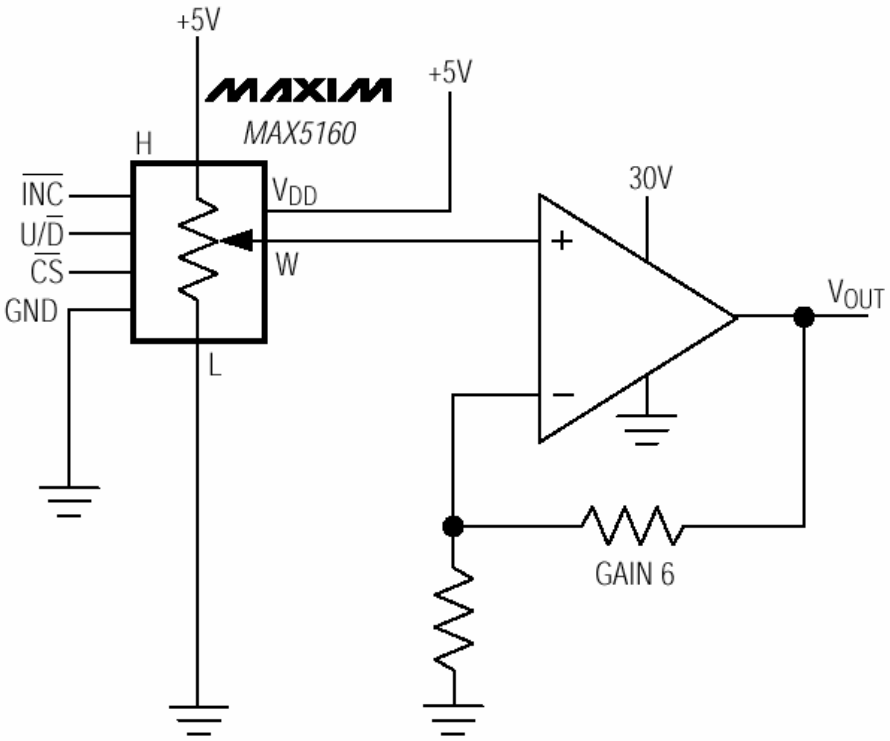
Digitales Potentiometer
Innenschaltung



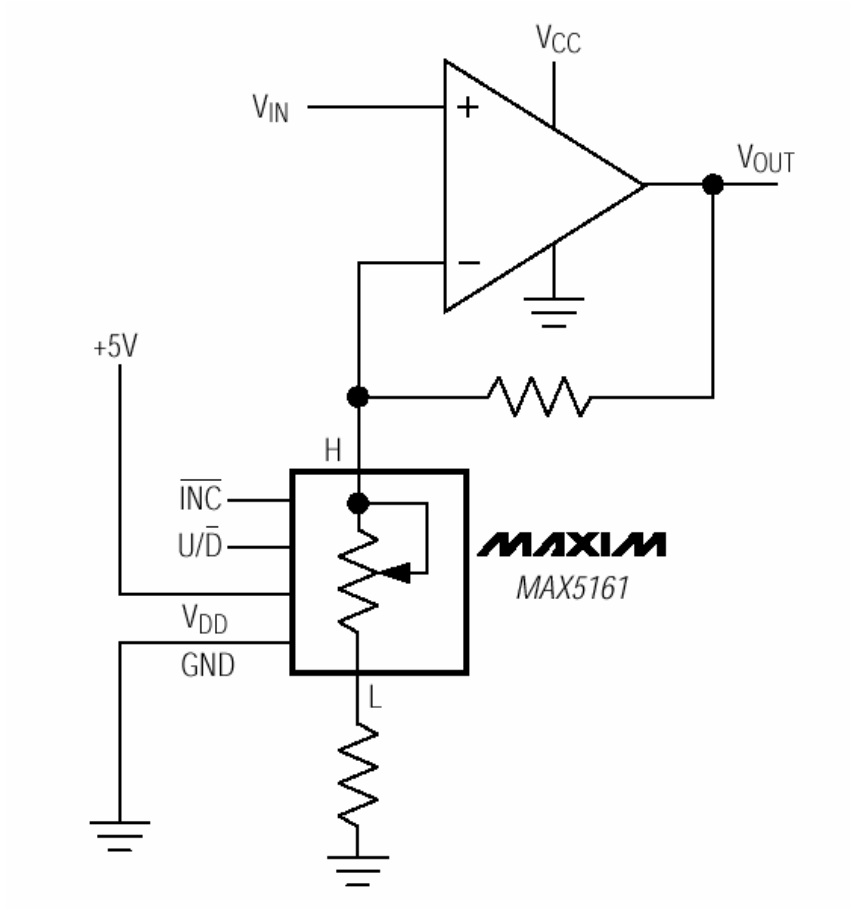
Digitales Potentiometer
Anschlußbelegung



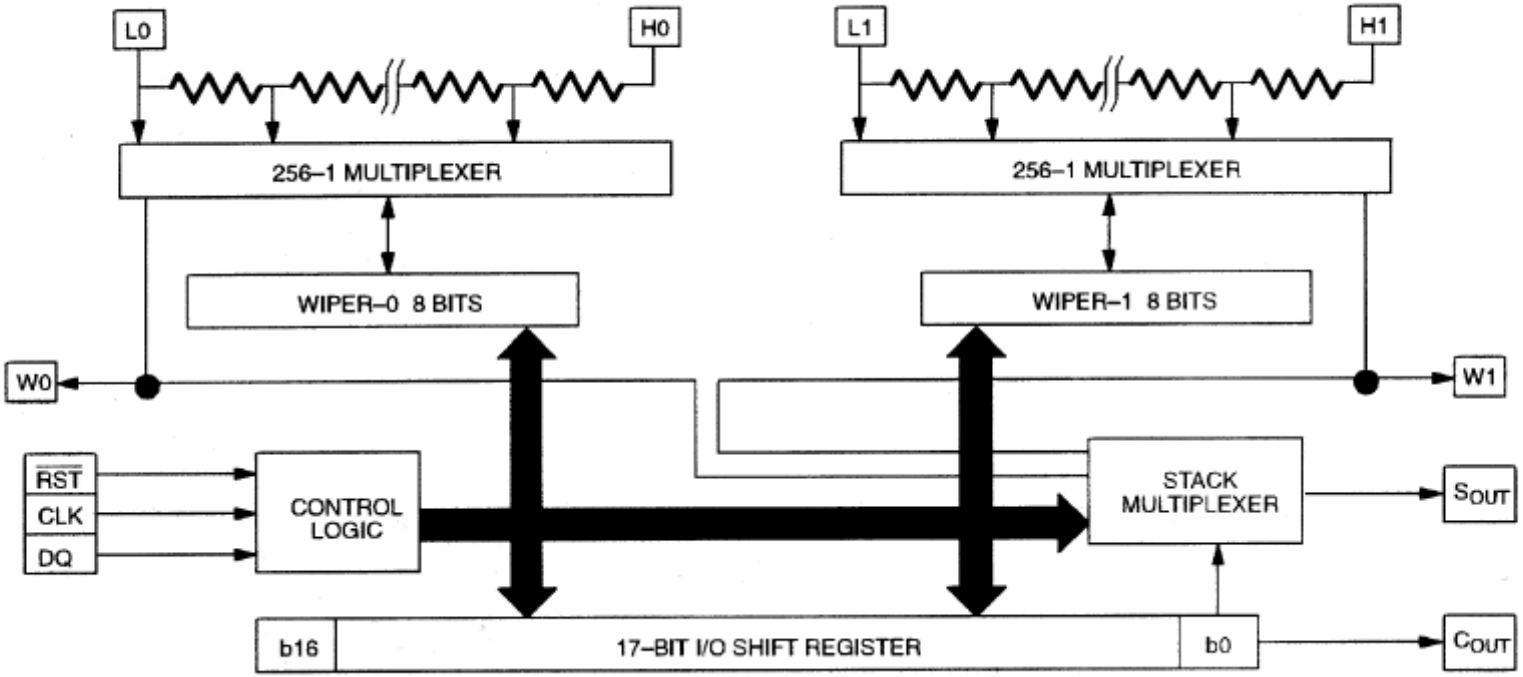
Digitales Potentiometer
LCD Spannungsversorgung



Digitales Potentiometer
Verstärkungssteuerung



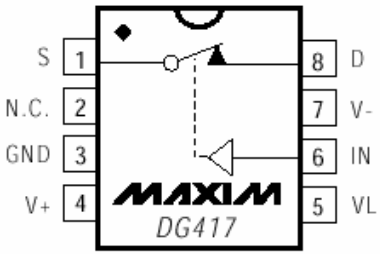
DS1868 BLOCK DIAGRAM Figure 1



Analogschalter

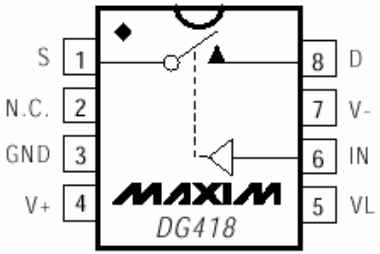
Pin Configurations/Functional Diagrams/Truth Tables

TOP VIEW



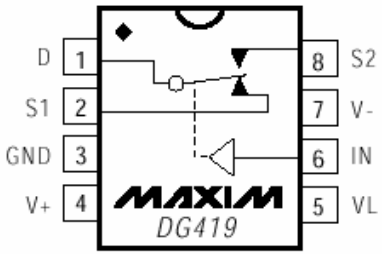
DIP/SO

DG417	
LOGIC	SWITCH
0	ON
1	OFF



DIP/SO

DG418	
LOGIC	SWITCH
0	OFF
1	ON



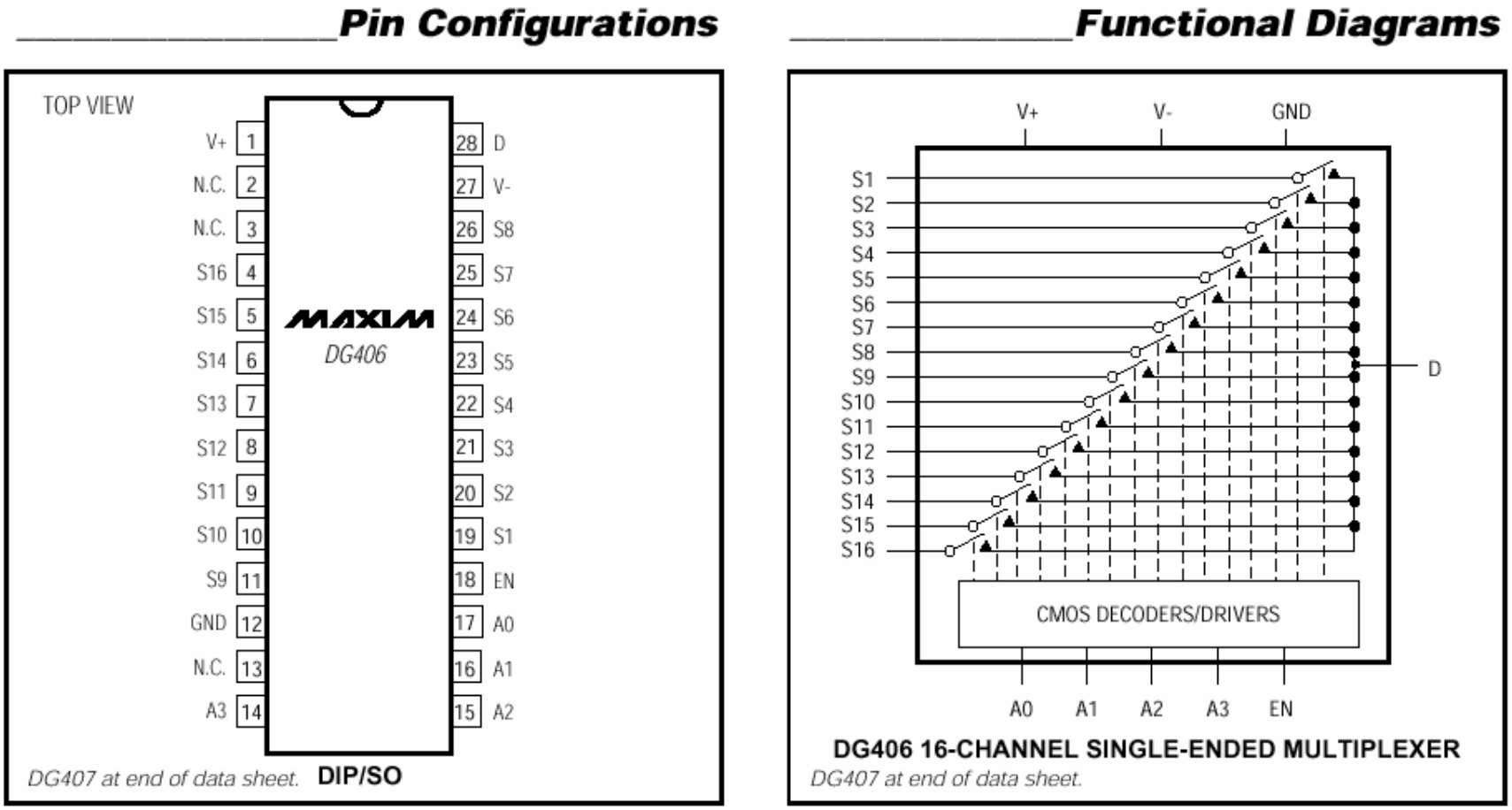
DIP/SO

DG419		
LOGIC	SWITCH 1	SWITCH 2
0	ON	OFF
1	OFF	ON

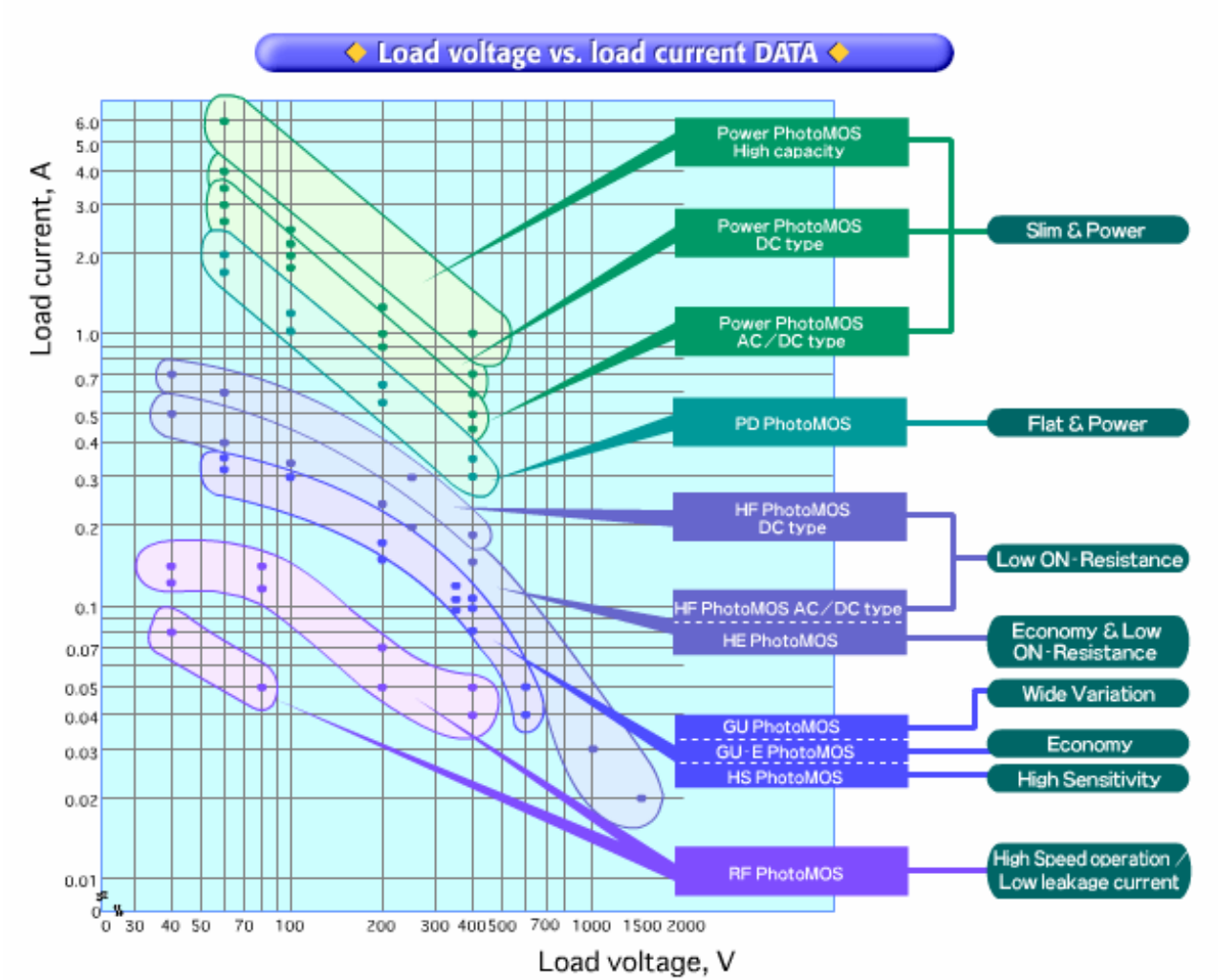
N.C. = NO INTERNAL CONNECTION

SWITCHES SHOWN FOR LOGIC "0" INPUT

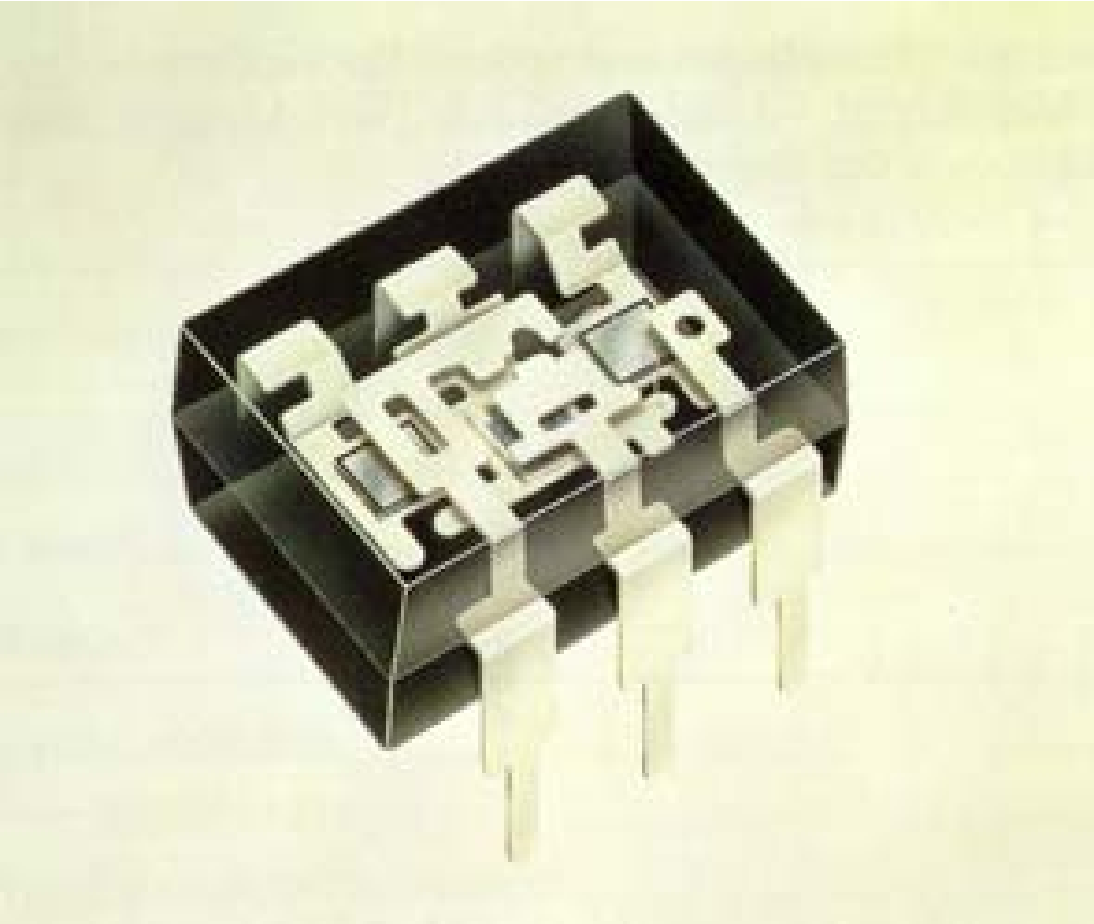
Analogmultiplexer



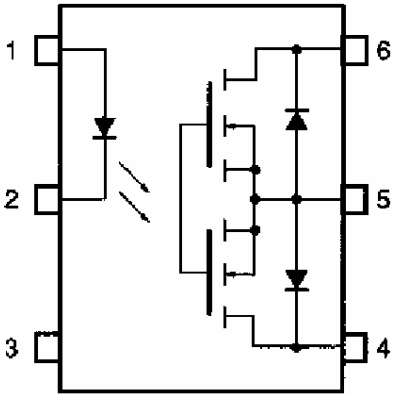
Halbleiterrelais



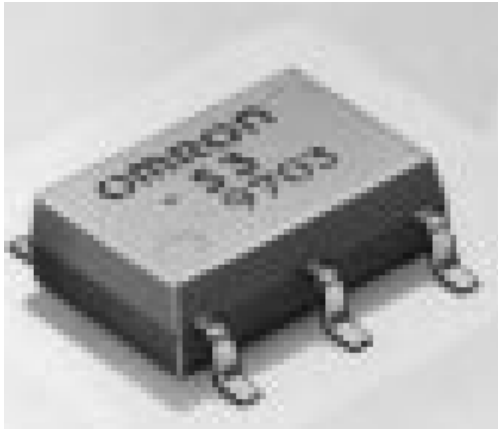
Halbleiterrelais



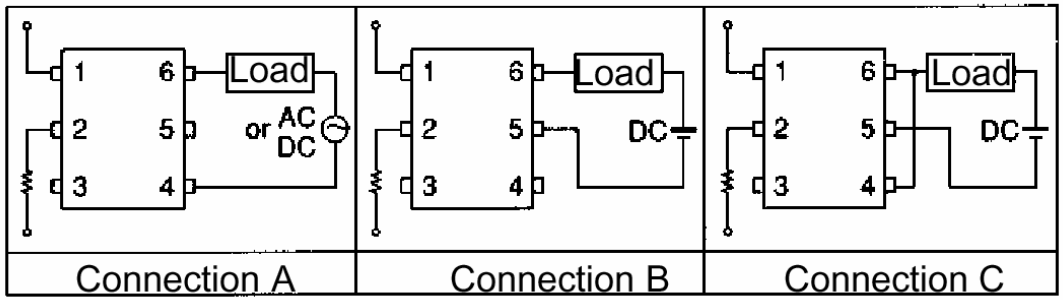
Halbleiterrelais



1: Anode
2: Cathode
4: Drain D1
5: Source
6: Drain D2



Connection diagram



Schaltvermögen
I=120mA
U=350VAC

Anwendungsbereites Wissen

- Anwendung und Nutzung von
  - Leuchtdiode
  - Fototransistor
  - Optokoppler
- Aufbau, Funktion und Kennlinien von
  - J-FET Transistor
  - MOS-FET Transistor
    - Anreicherungstyp selbst sperrend
    - Verarmungstyp selbst leitend
    - Kennlinienfeld
- Grundschaltungen
  - Schalter
  - Verstärker
  - Inverter
  - Tristate
  - Transmissionsgatter